

Calculatoare Numerice (2)

- **Cursul 1** -

Sistemul de memorie (1)

Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea Politehnica București

HEY, PAL, I'VE FINALLY UNDERSTOOD HOW MY CPU WORKS AND WHY IT CRASHES SOMETIMES WHEN I TRY TO RUN SOME NASTY CODE!



OH, YOU THINK SO?

OH, YEAH, I'VE JUST PAST MY "CN1st" COURSE



HMM... AND YOU THINK THAT'S ALL?

WHAT DO YOU MEAN
....



YOU KNOW SO LITTLE...
OH, WAIT... THERE'S MORE!



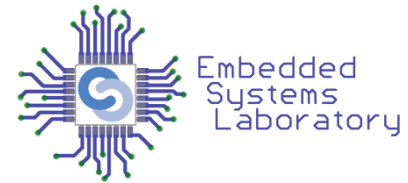
MY ULTIMATE IS READY...
... THERE IT COMES... 'CN2'!!



...

TO BE CONTINUED...

Proiectarea sistemului de memorie



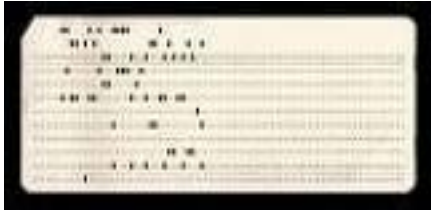
Probleme de proiectare – Vrem un circuit de memorie:

- Poate să țină pasul cu viteza de execuție a CPU
- Are destulă capacitate pentru program și date
- Ieftină, fiabilă și eficientă energetic

Tehnologia și organizarea memoriei principale a unui calculator

- SRAM (cache), DRAM (main), și flash (nonvolatile)
- Întrețesere & pipelining pentru a combate “memory wall”

Primele tehnologii de fabricație pentru memoria Read-Only

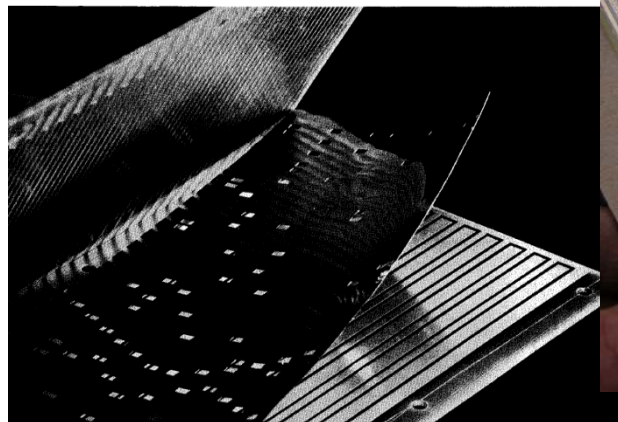
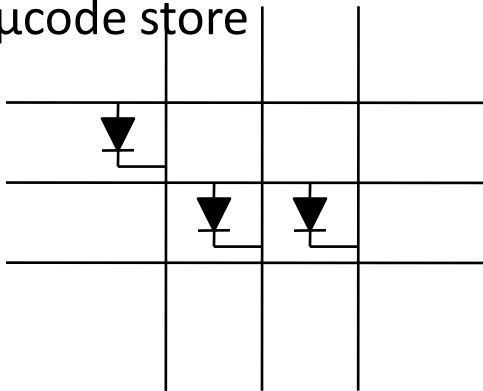


Cartele perforate , din anii 1700, războaie Jaquard,

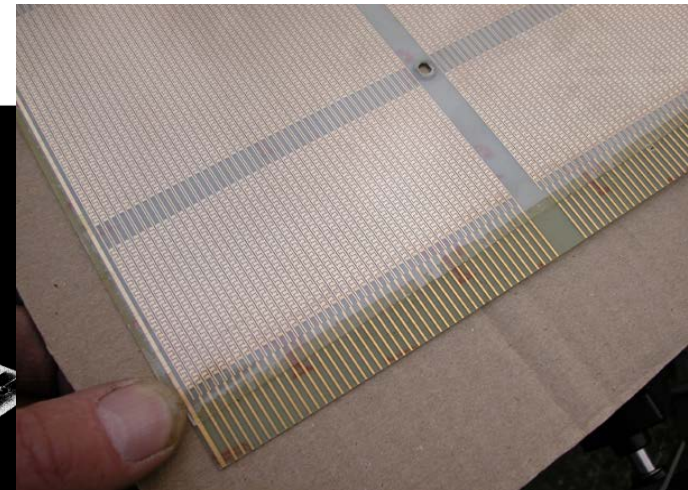
Babbage, IBM până în anii '80 Bandă perforată – programul rulat de Harvard Mk 1



Diode Matrix, EDSAC-2
μcode store



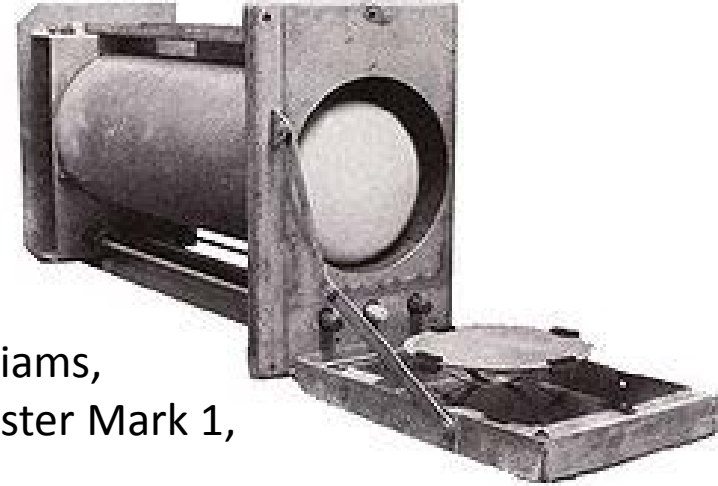
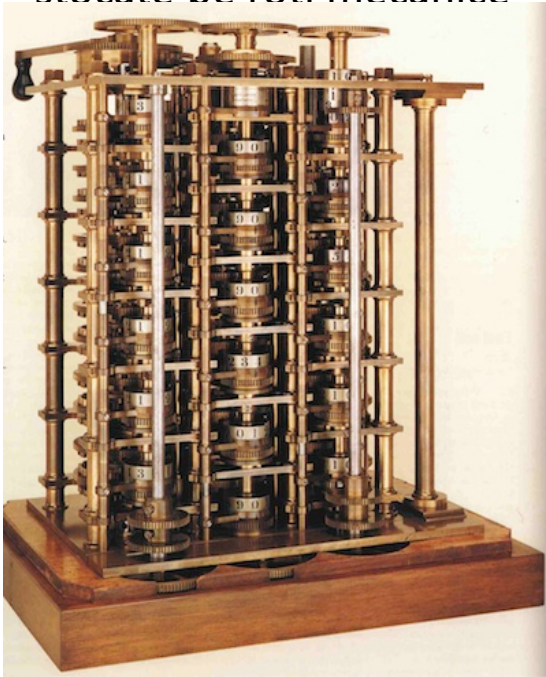
IBM Card Capacitor ROS



IBM Balanced Capacitor ROS

Primele tehnologii de fabricație pentru memoria Read-Write

Babbage, anii 1800: Cifre stocate pe roți mecanice



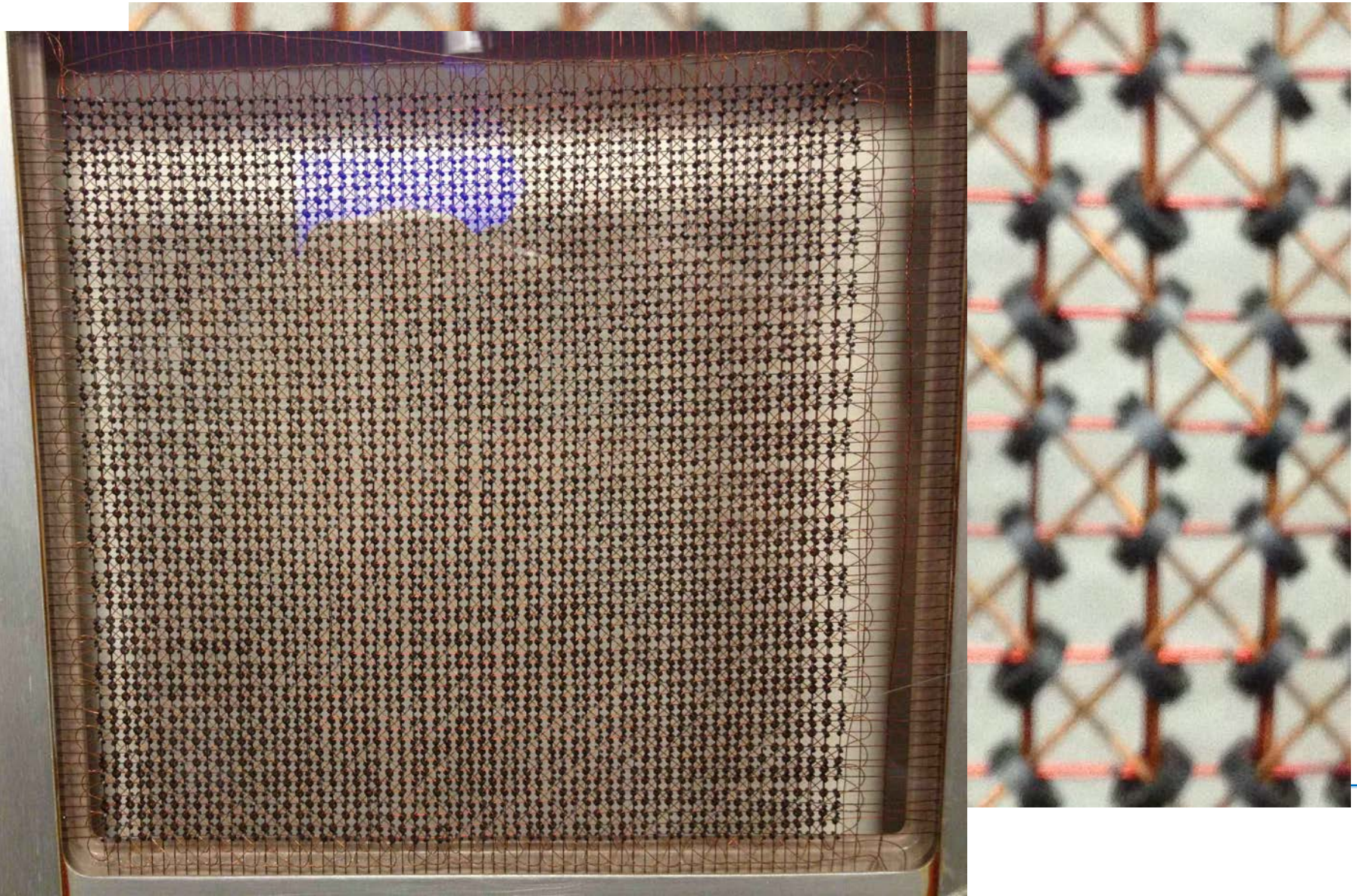
Tub Williams,
Manchester Mark 1,
1947

Mercury Delay Line, Univac 1, 1951



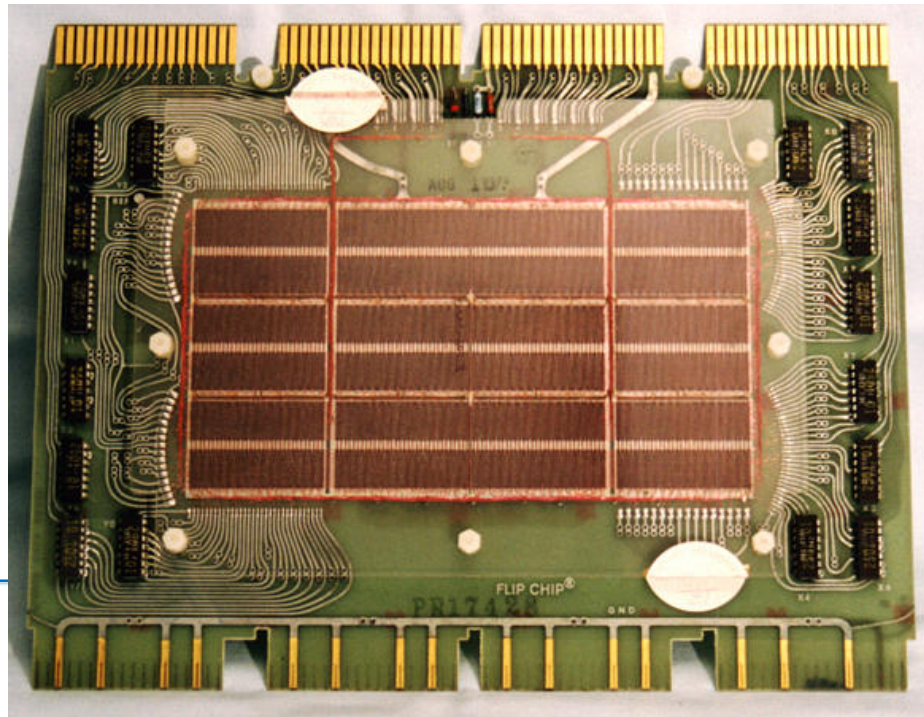
Memorie regenerativă cu condensatoare pentru calculatorul Atanasoff-Berry și memorie pe tambur magnetic rotativ pentru IBM 650

Memorie pe miez de ferită - MIT Whirlwind



Memoria pe miez de ferită

- A fost prima tehnologie de fabricație fiabilă pentru memoriile principale
 - Inventată de Forrester sfârșitul anilor 40/începutul anilor 50 la MIT pentru proiectul Whirlwind
 - Biți stocați prin polarizarea magnetică a unor miezuri foarte mici de ferită țesute într-o matrice bidimensională de fire conductoare
 - Pulsurile concomitente de curent pe conductorii X și Y pot scrie starea bitului de memorie și să citească starea originală (destructive read)
-
- Stocare robustă, non-volatilă
 - Folosită la primele nave spațiale (de la Apollo la navetele spațiale)
 - Inelele de ferită țesute de mână (25 de miliarde/an)
 - Timp de acces $\sim 1\mu s$



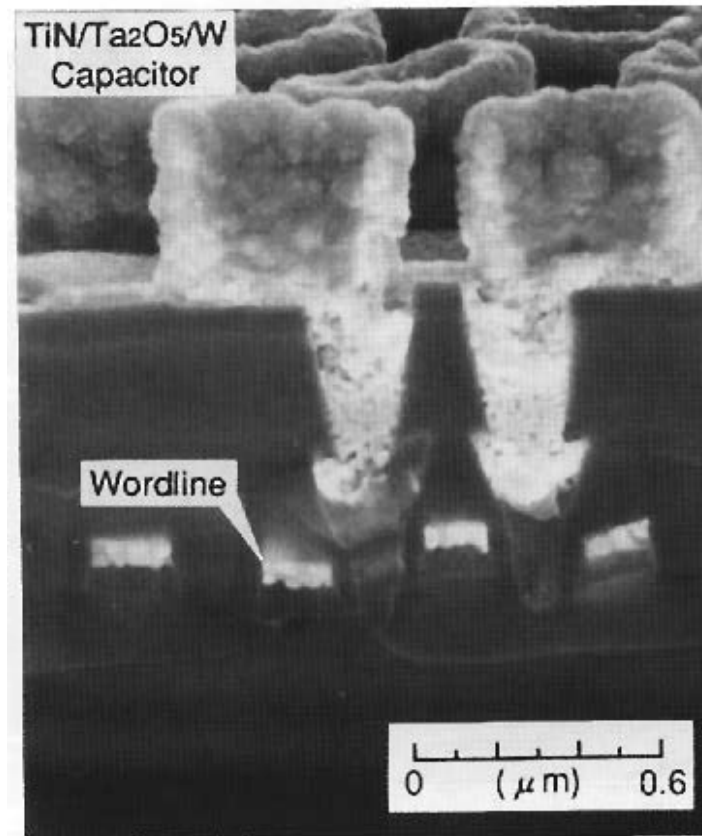
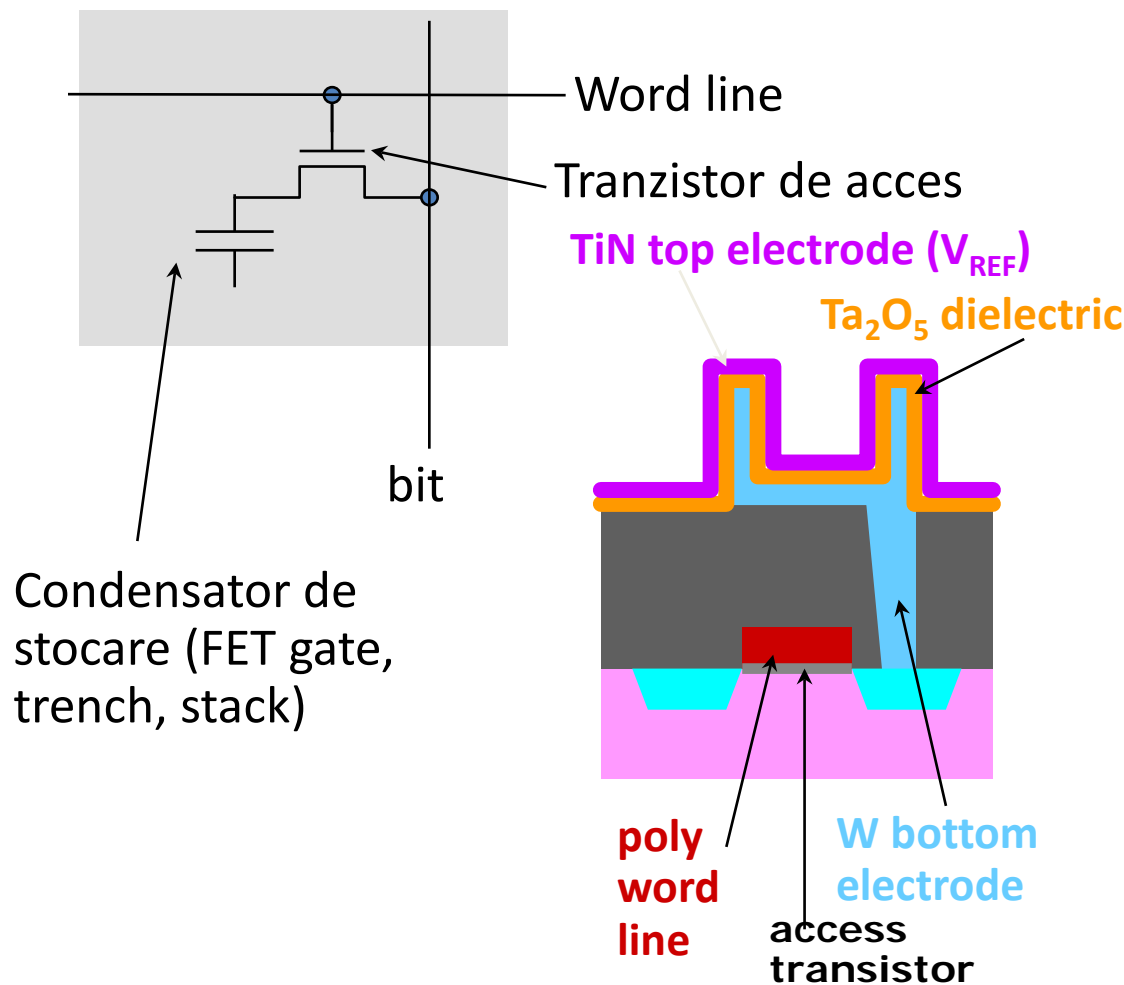
- Memoriile semiconductoare au început să fie competitive în anii 70
 - Intel a apărut pentru a exploata piața memoriilor semiconductoare
 - Primele memorii semiconductoare au fost RAM-urile Statice (SRAM). Structura internă a unei celule SRAM este similară cu aceea a unui latch (inversoare în anti-paralel).
- Primul RAM Dinamic (DRAM) comercial a fost chipul Intel 1103
 - 1Kbit de memorie pe un singur chip
 - Sarcina unui condensator este folosită pentru a memora un bit

Memoria semiconductoare a înlocuit rapid memoria pe miez de ferită în anii 70

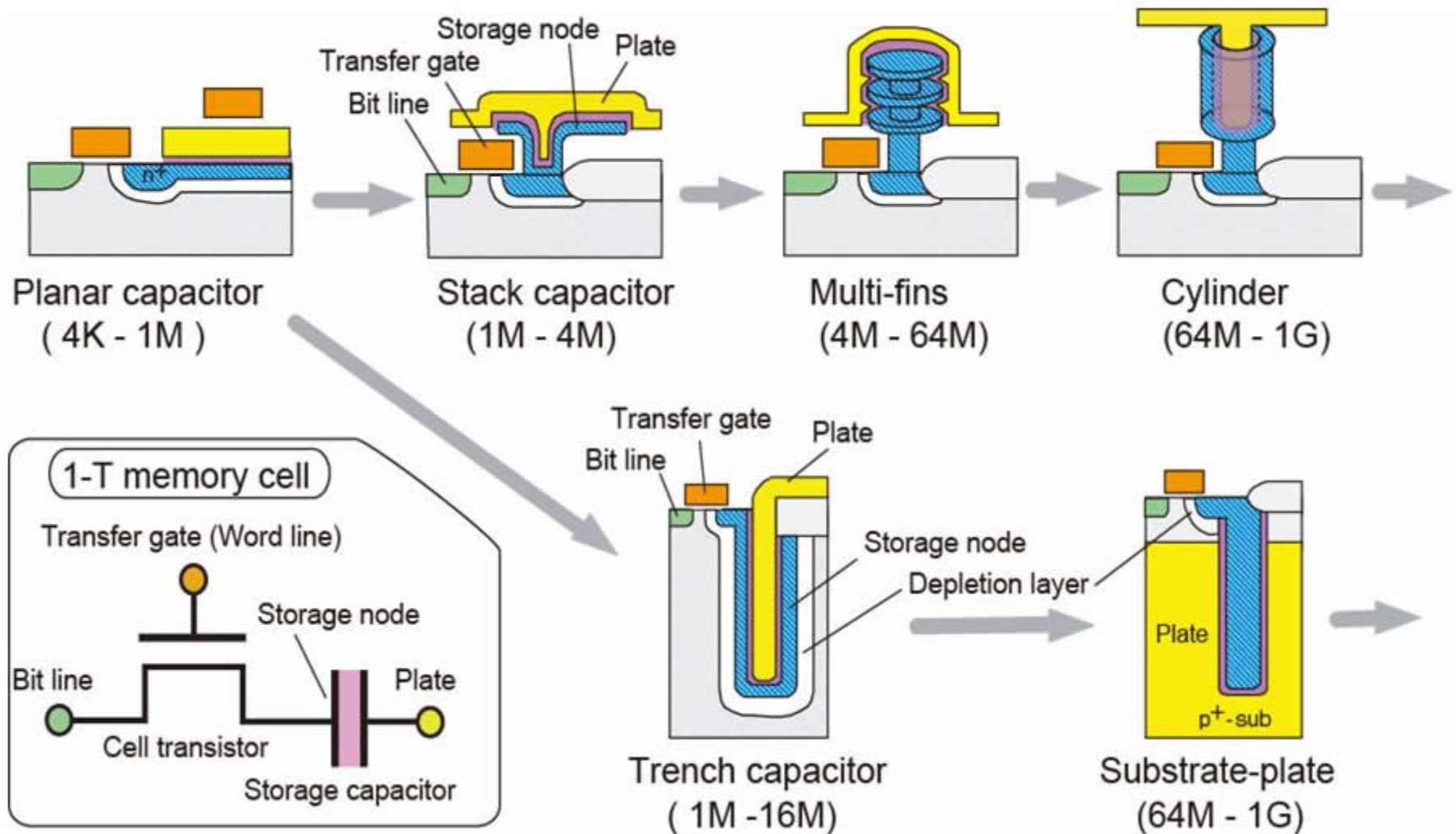
One-Transistor Dynamic RAM

[Dennard, IBM]

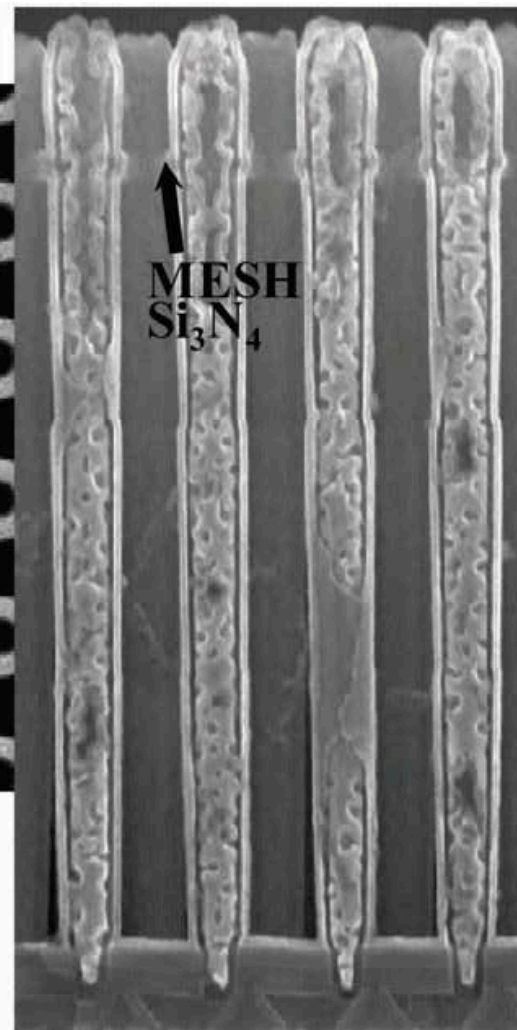
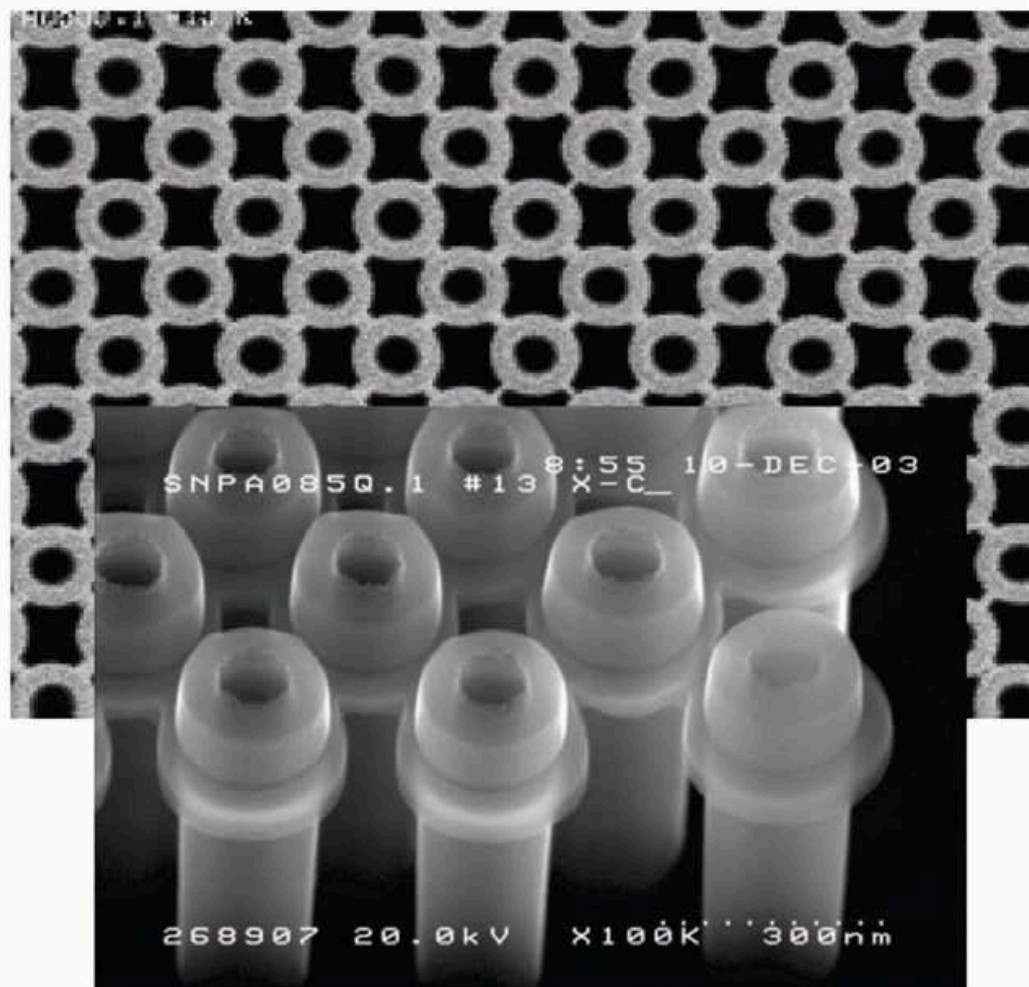
1-T DRAM Cell



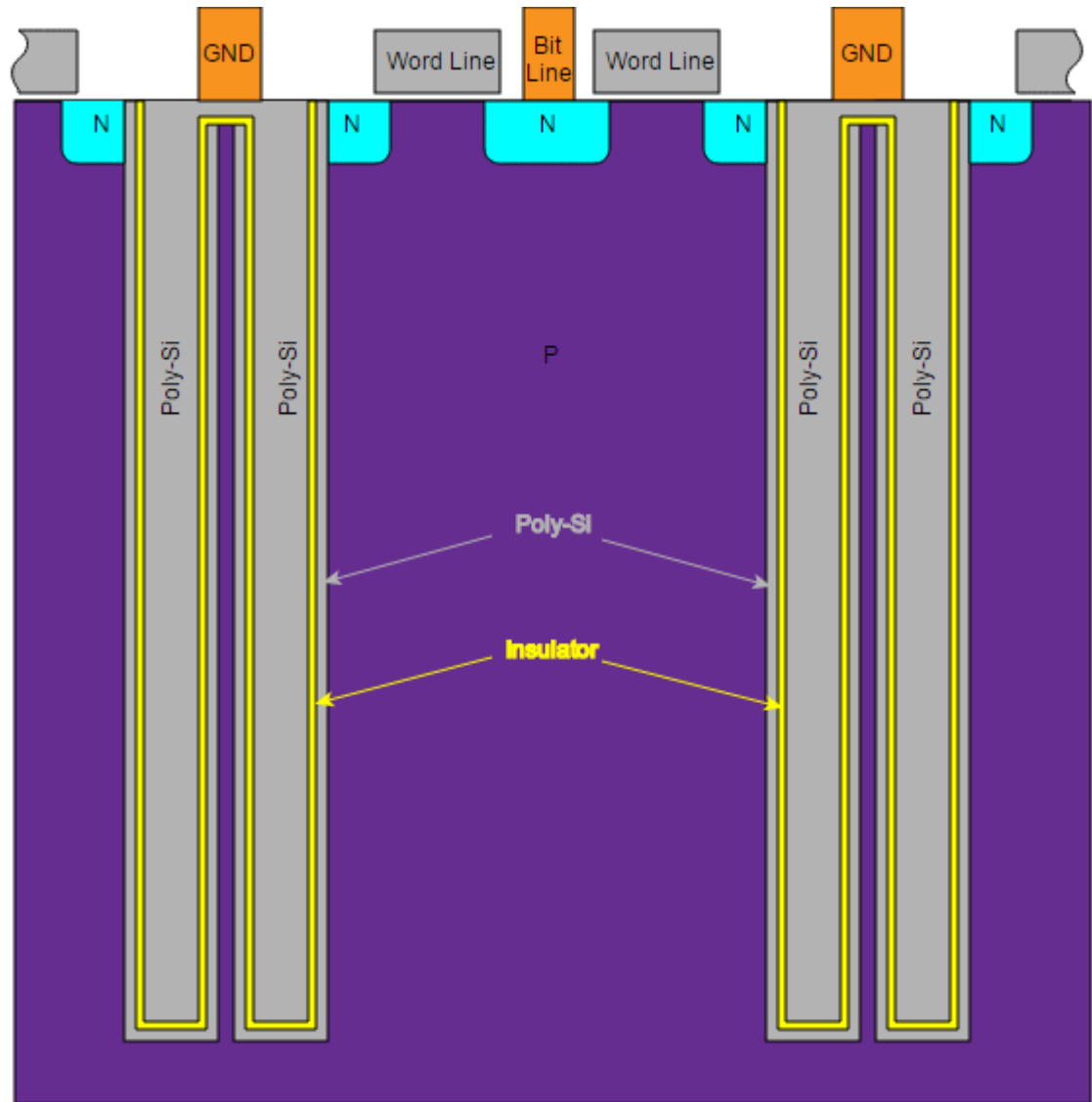
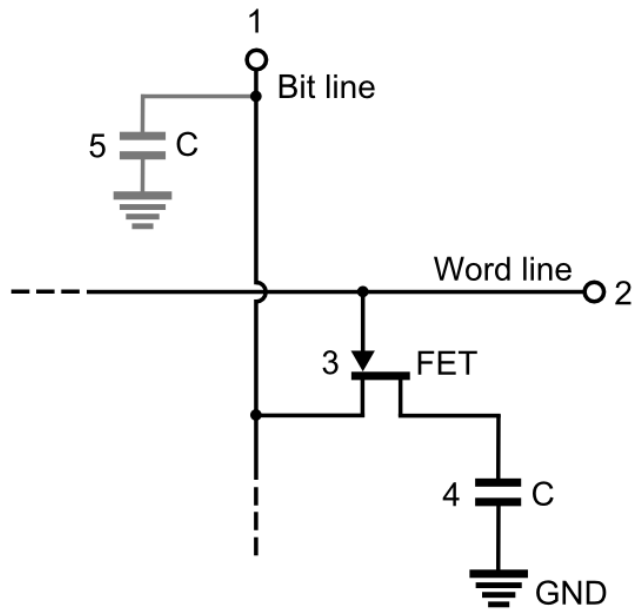
DRAM Scaling



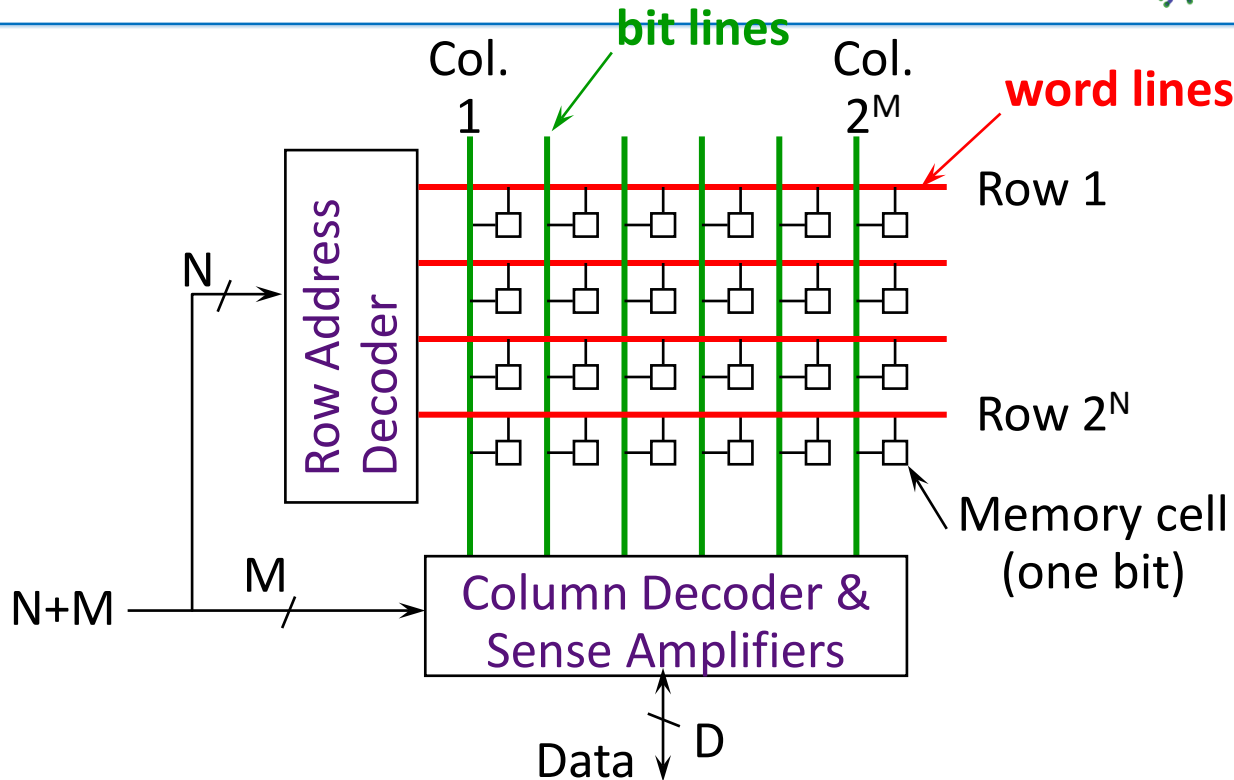
Structura modernă a unui DRAM



Structura Internă

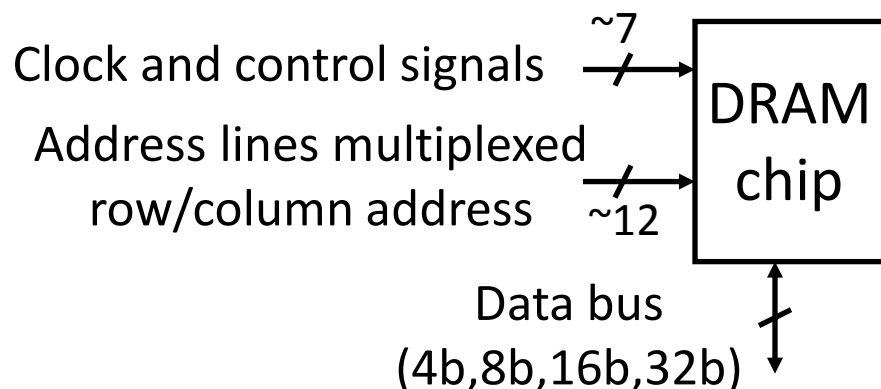


Arhitectura DRAM

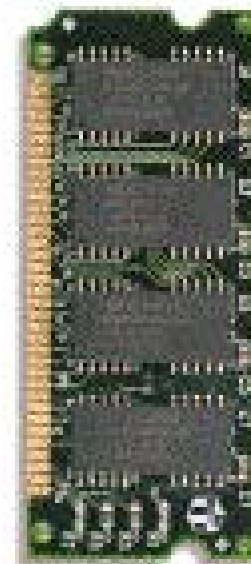


- Biții sunt stocați în matrici bidimensionale pe chip
- Chipurile moderne au în jur de 4-8 bancuri logice
fiecare banc logic este implementat fizic ca o matrice de biți

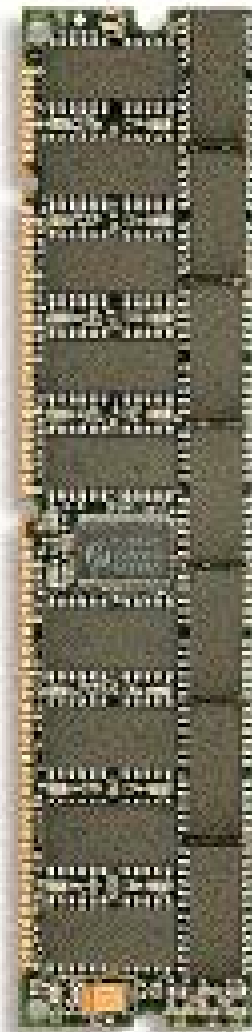
Încapsularea DRAM (Laptop-uri/Desktop-uri/Servere)



- DIMM (Dual Inline Memory Module) conține mai multe chipuri cu semnalele de ceas/control/adresă conectate în paralel (câteodată este nevoie de buffering pentru a duce semnalele la toate chipurile)
- Pinii de date lucrează împreună pentru a returna un cuvânt întreg (de. ex., bus de date de 64 de biți cu patru chipuri de 16 biți)



72-pin SO DIMM

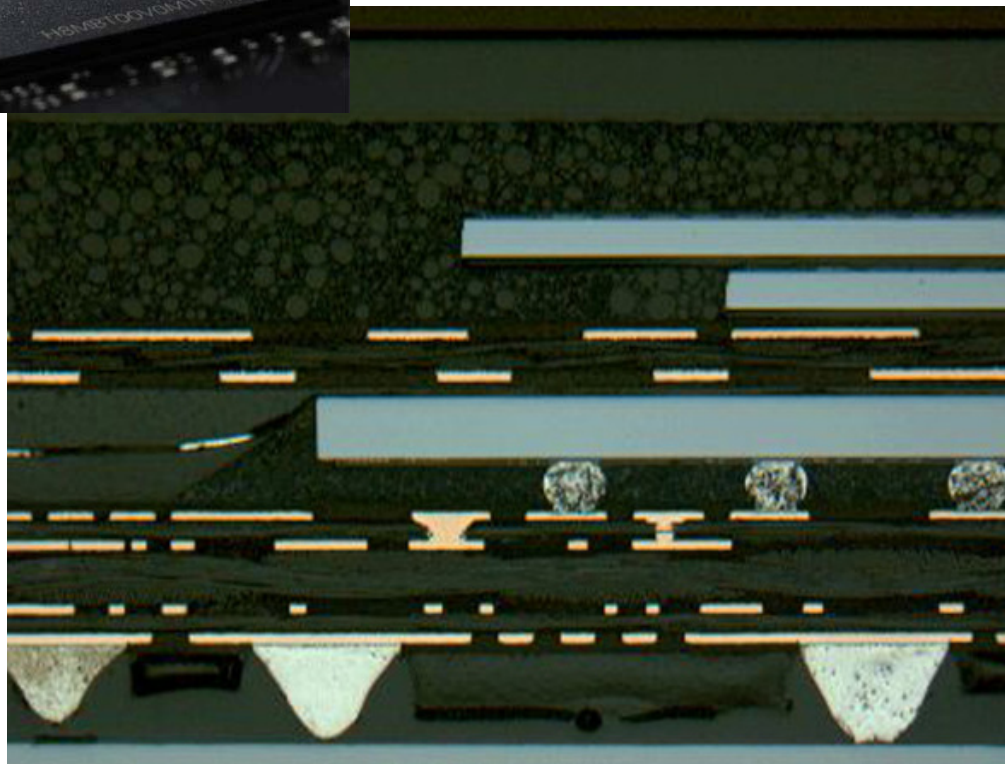


168-pin DIMM

Încapsularea DRAM, Dispozitive mobile



[Capsulă Apple A4 pe PCB]

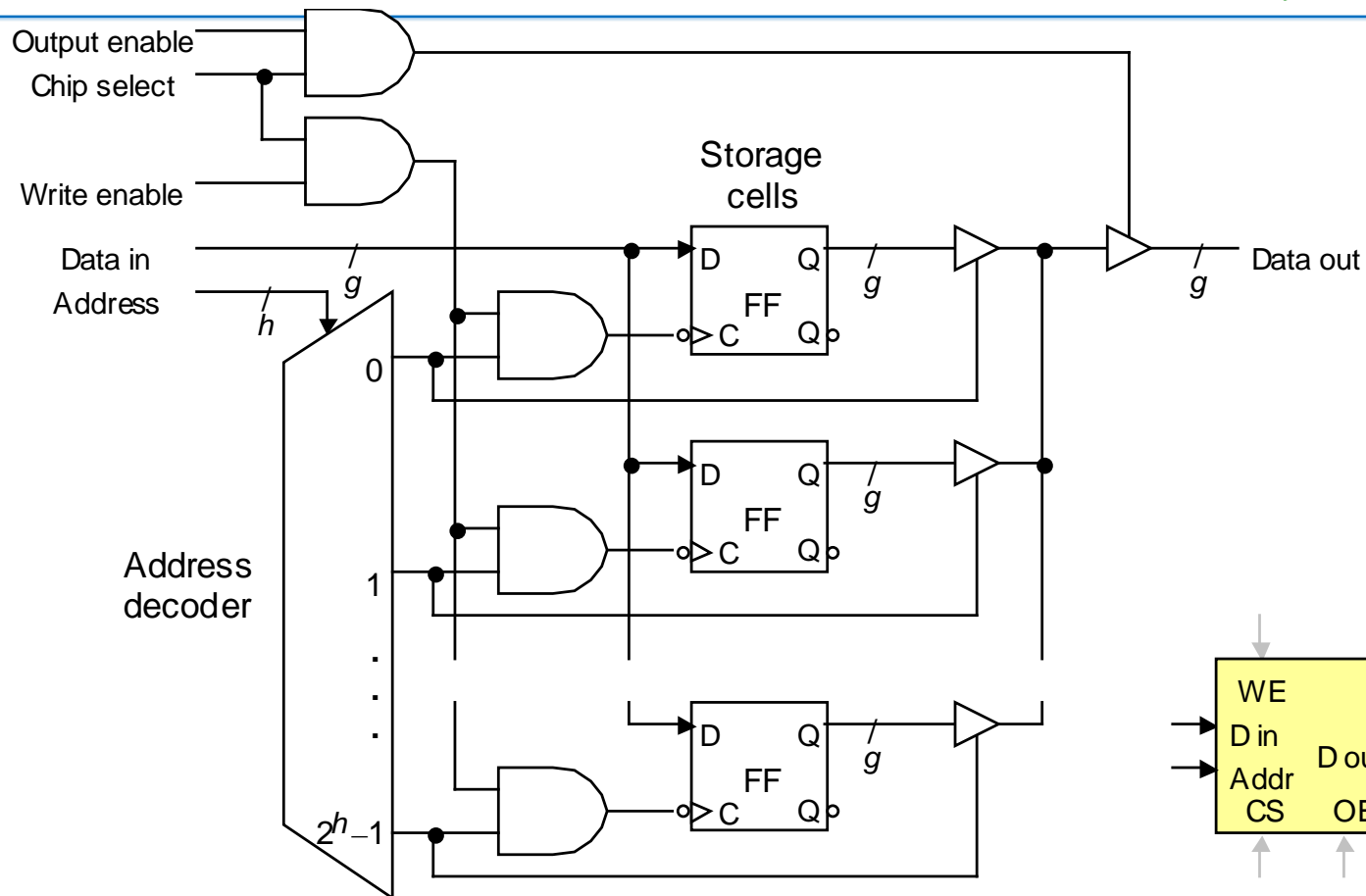


Two
stacked
DRAM die

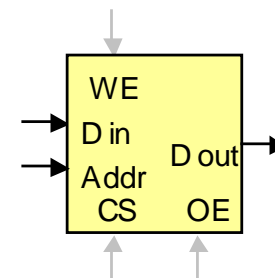
Processor
plus logic
die

[Capsulă Apple A4 în secțiune, iFixit 2010]

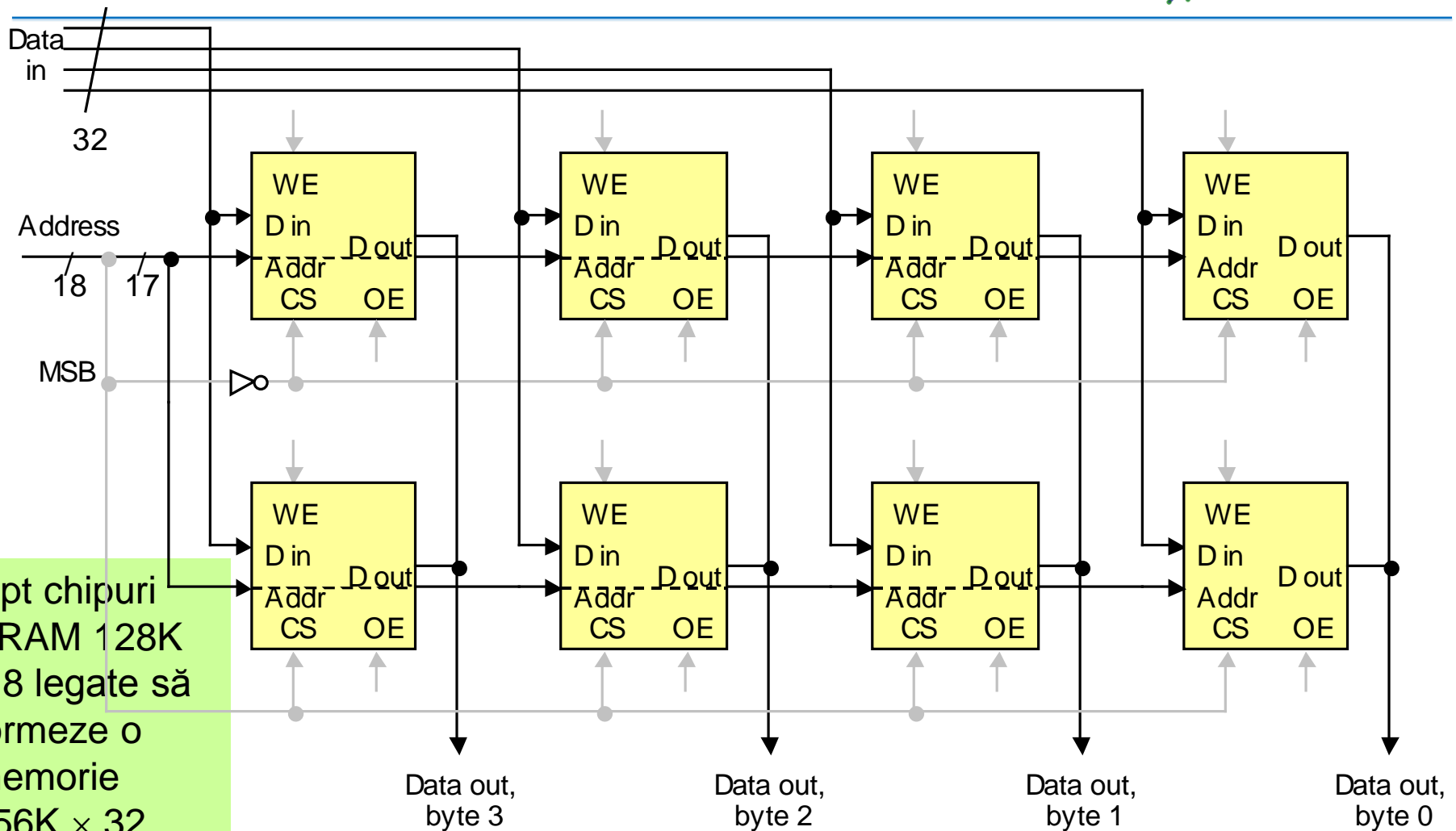
Structura memoriei SRAM



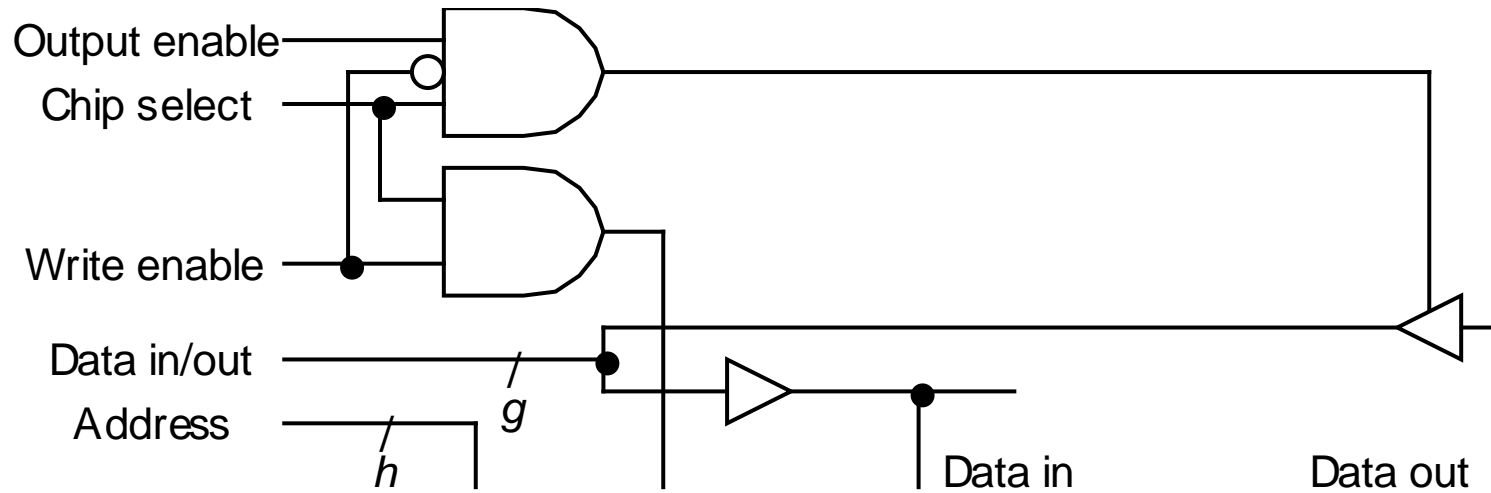
Structura interioară a unui chip SRAM $2^h \times g$ și simbolul lui echivalent în schema electrică.



Multiple-Chip SRAM



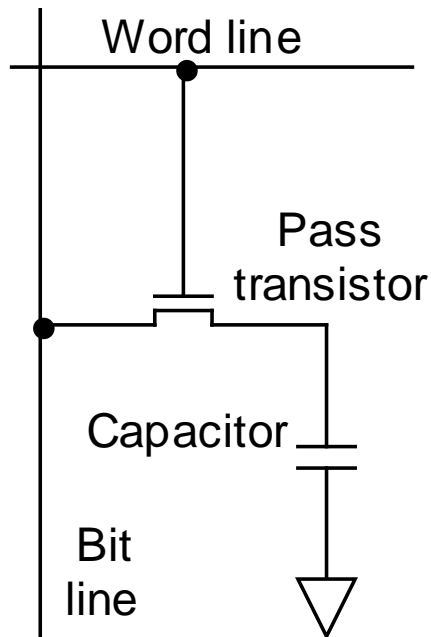
SRAM cu bus de date bidirecțional



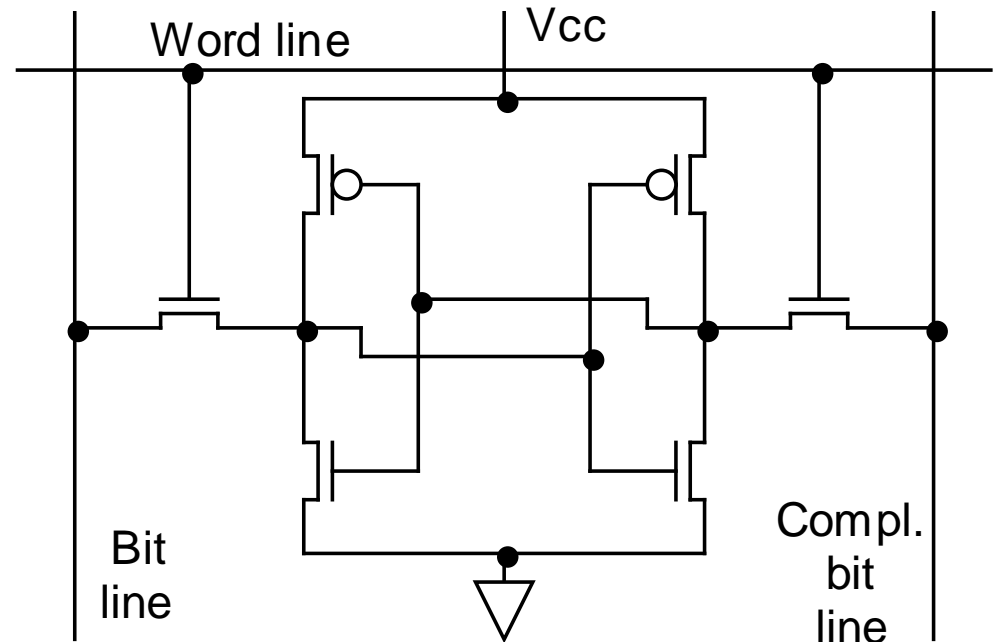
Atunci când intrarea și ieșirea de date a unui chip SRAM sunt partajate sau conectate la un bus bidirecțional, ieșirea trebuie dezactivată în timpul operațiilor de scriere.

Memoria DRAM și ciclii de refresh

DRAM vs. SRAM – complexitatea unei celule de memorie



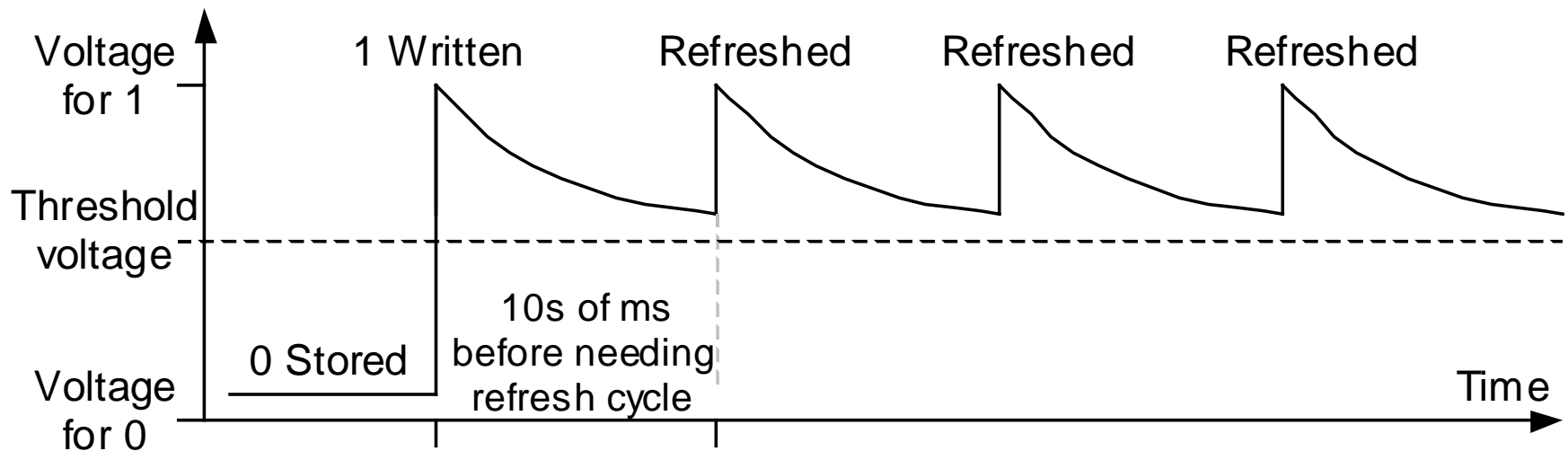
(a) DRAM cell



(b) Typical SRAM cell

Celula de memorie DRAM conține un singur tranzistor și e mult mai simplu de fabricat decât analogul ei SRAM => memorii DRAM de capacitate mai mare și mai dense.

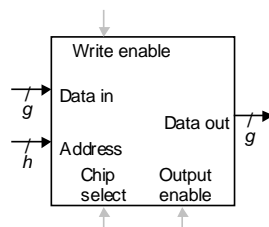
Ciclii și rata de refresh pentru memoria DRAM



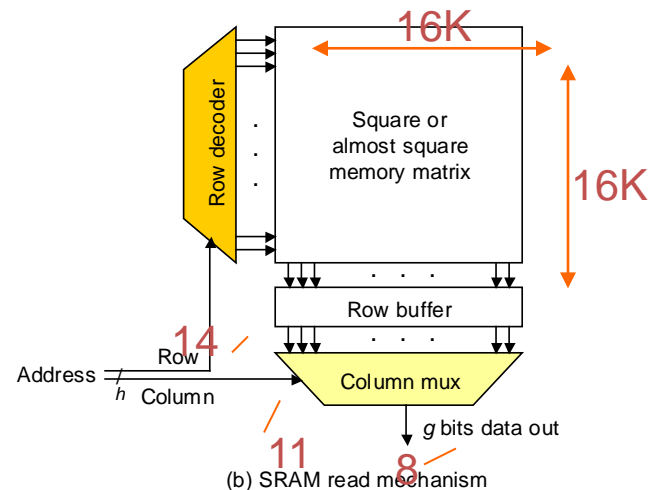
Variația căderii de tensiune pe condensatorul unei celule DRAM după scrierea unui 1 logic și a mai multor operații de refresh.

Pierdere la lățime de bandă cu cicli de refresh

O memorie DRAM de 256 Mb e organizată ca $32M \times 8$ intern și $16K \times 16K$ intern. Rândurile trebuie reîmprospătate cel puțin la fiecare 50ms pentru a nu pierde datele; refresh-ul pentru o coloană durează 100ns. Cât % din lățimea totală de bandă este pierdută cu cicli de refresh?



(a) SRAM block diagram



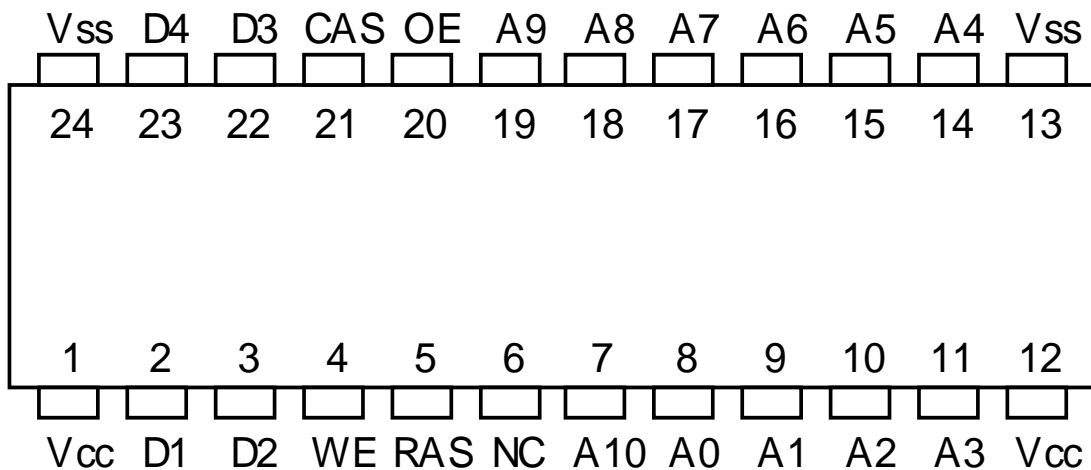
(b) SRAM read mechanism

Soluție

Refresh-ul pt toate 16K rânduri durează $16 \times 1024 \times 100 \text{ ns} = 1.64 \text{ ms}$. Pierdere a 1.64 ms la fiecare 50 ms duce la $1.64/50 = 3.3\%$ pierdere din lățimea totală de bandă.

Încapsularea DRAM

24-pin dual in-line package (DIP)

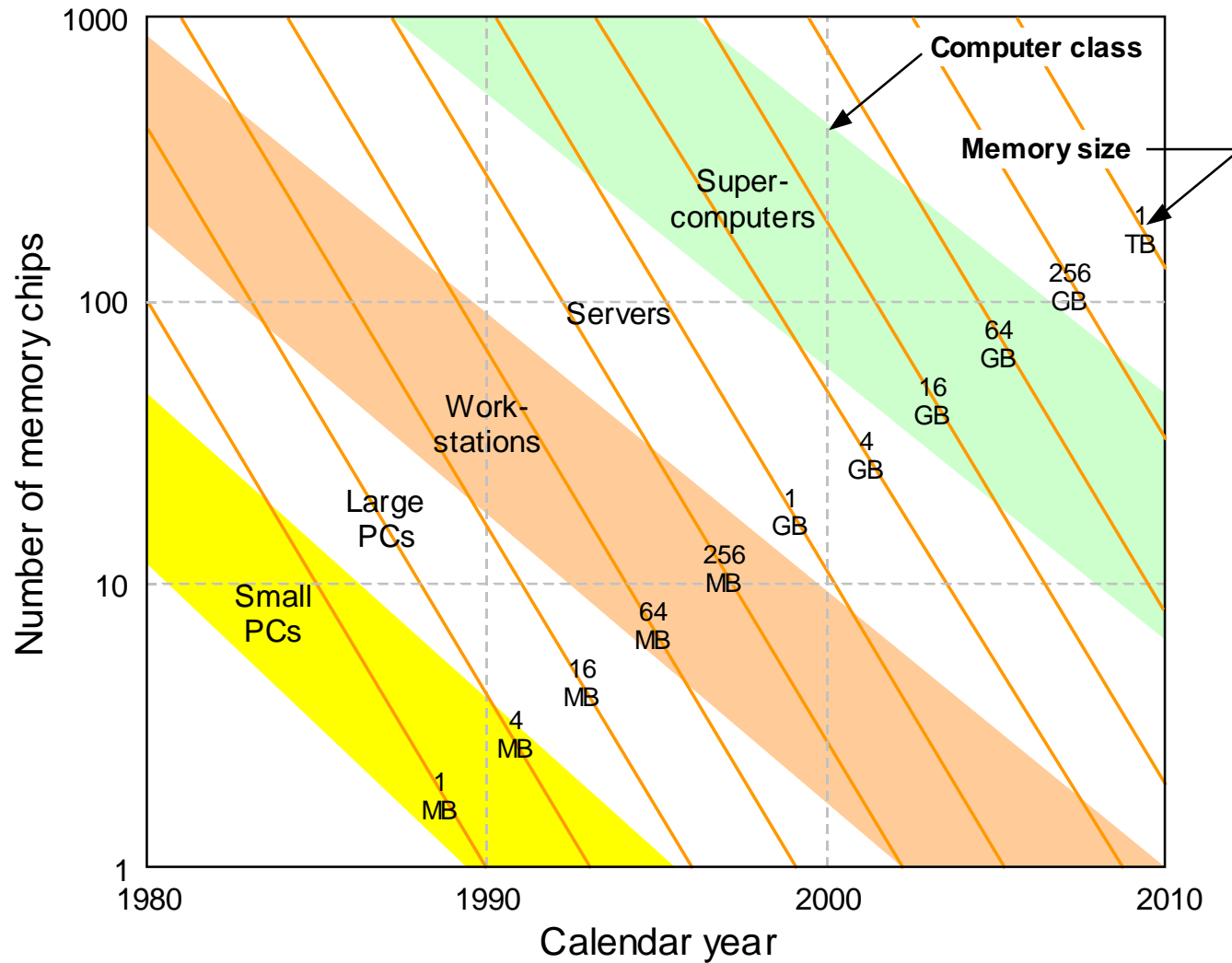


Legend:

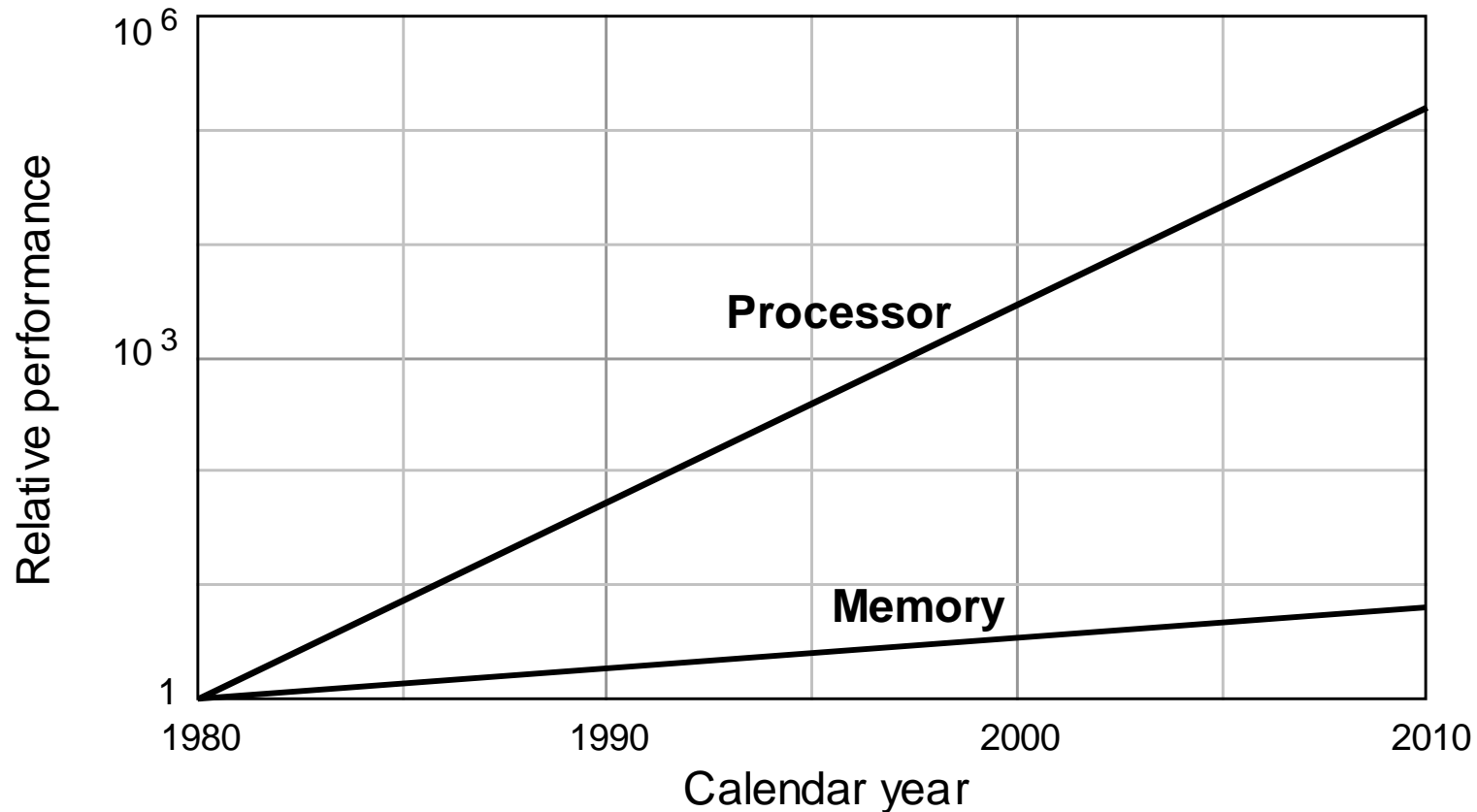
A_i	Address bit i
CAS	Column address strobe
D_j	Data bit j
NC	No connection
OE	Output enable
RAS	Row address strobe
WE	Write enable

Capsulă tipică DRAM ce conține o memorie $16M \times 4$.

Evoluția DRAM



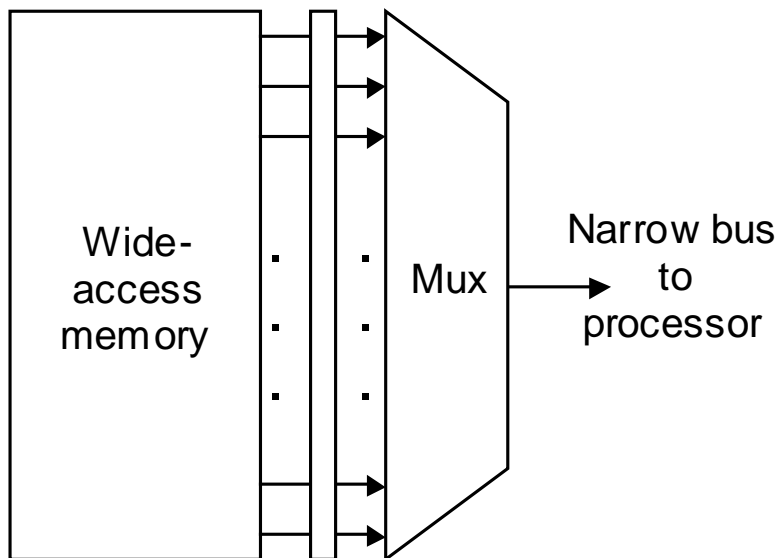
Atingerea zidului memoriei



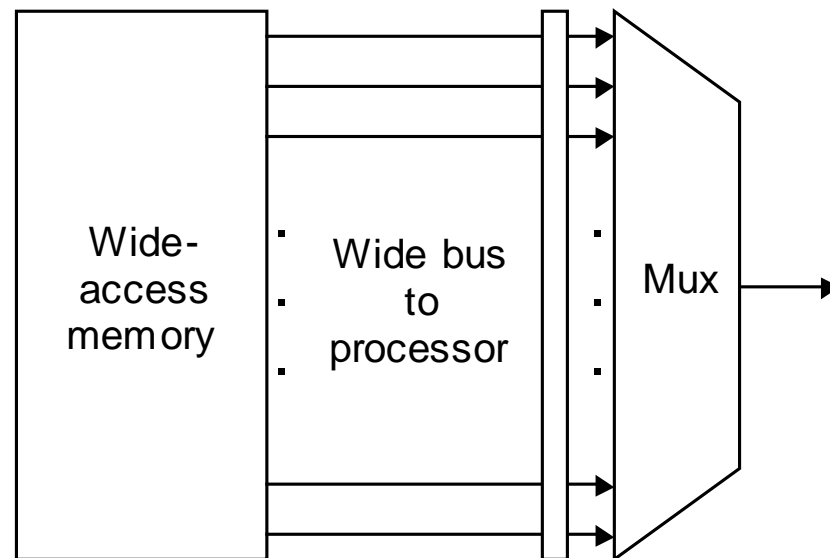
Densitatea și capacitatea memoriei au crescut odată cu puterea și complexitatea CPU, dar viteza memoriei nu a ținut pasul.

Trecerea prăpastiei de viteză CPU-Memorie

Idee: Citim mai multe date din memorie la fiecare acces



(a) Buffer and multiplexer at the memory side



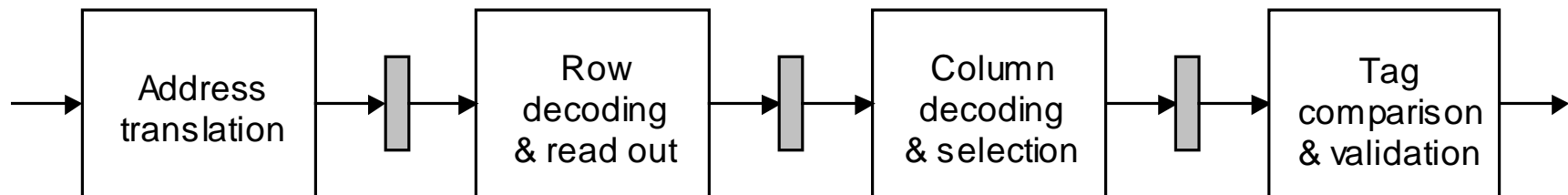
(a) Buffer and multiplexer at the processor side

Două căi de a folosi o memorie cu lățime mare de bandă pentru a reduce diferența de viteză dintre procesor și memorie.

Memorie în b.a. și întrețesută

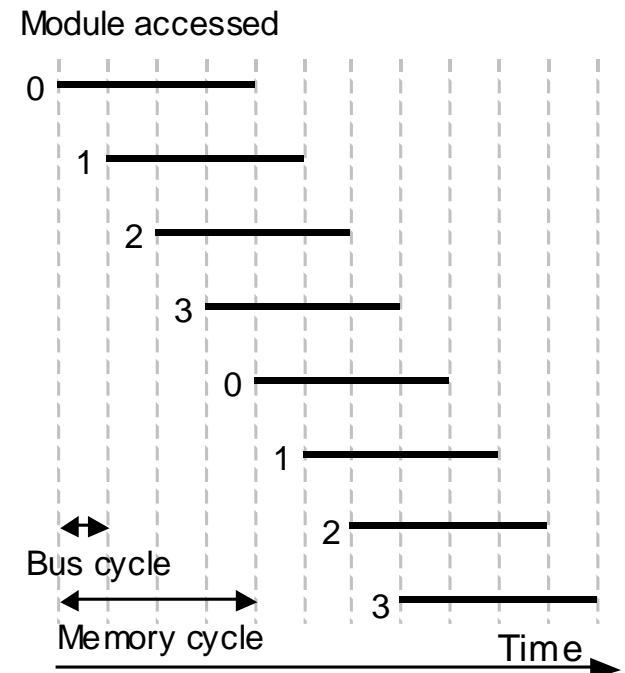
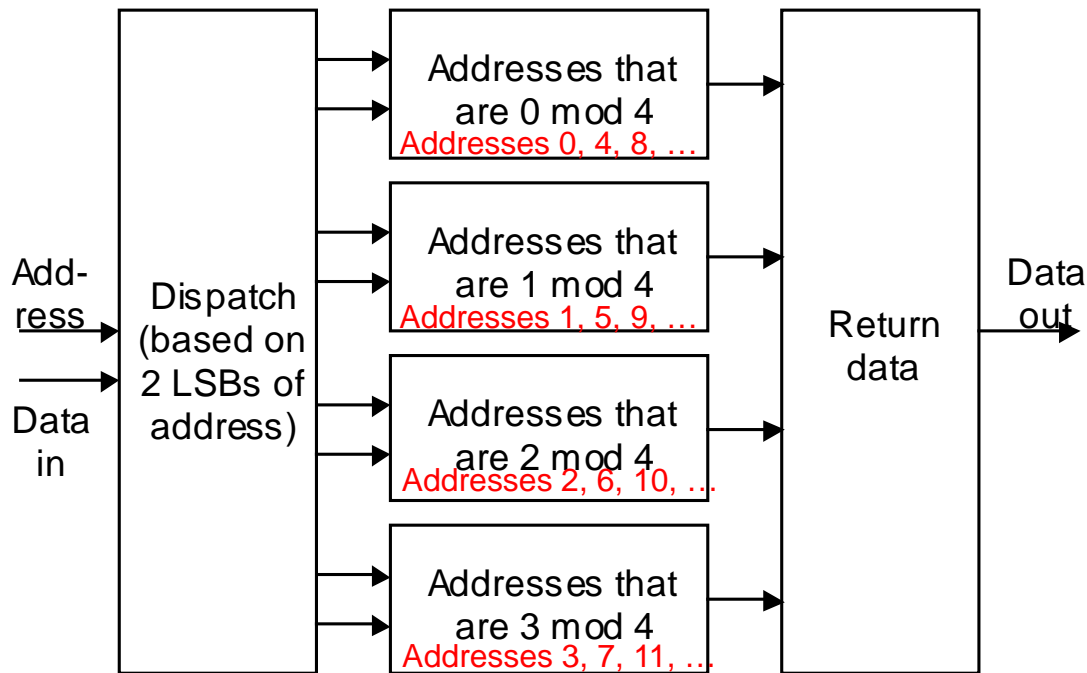
Latența memoriei poate fi dată și de alți factori, în afară de timpul de acces fizic.

- Translatarea adresei virtuale
- Compararea etichetelor pentru a determina rata hit/miss pentru cache



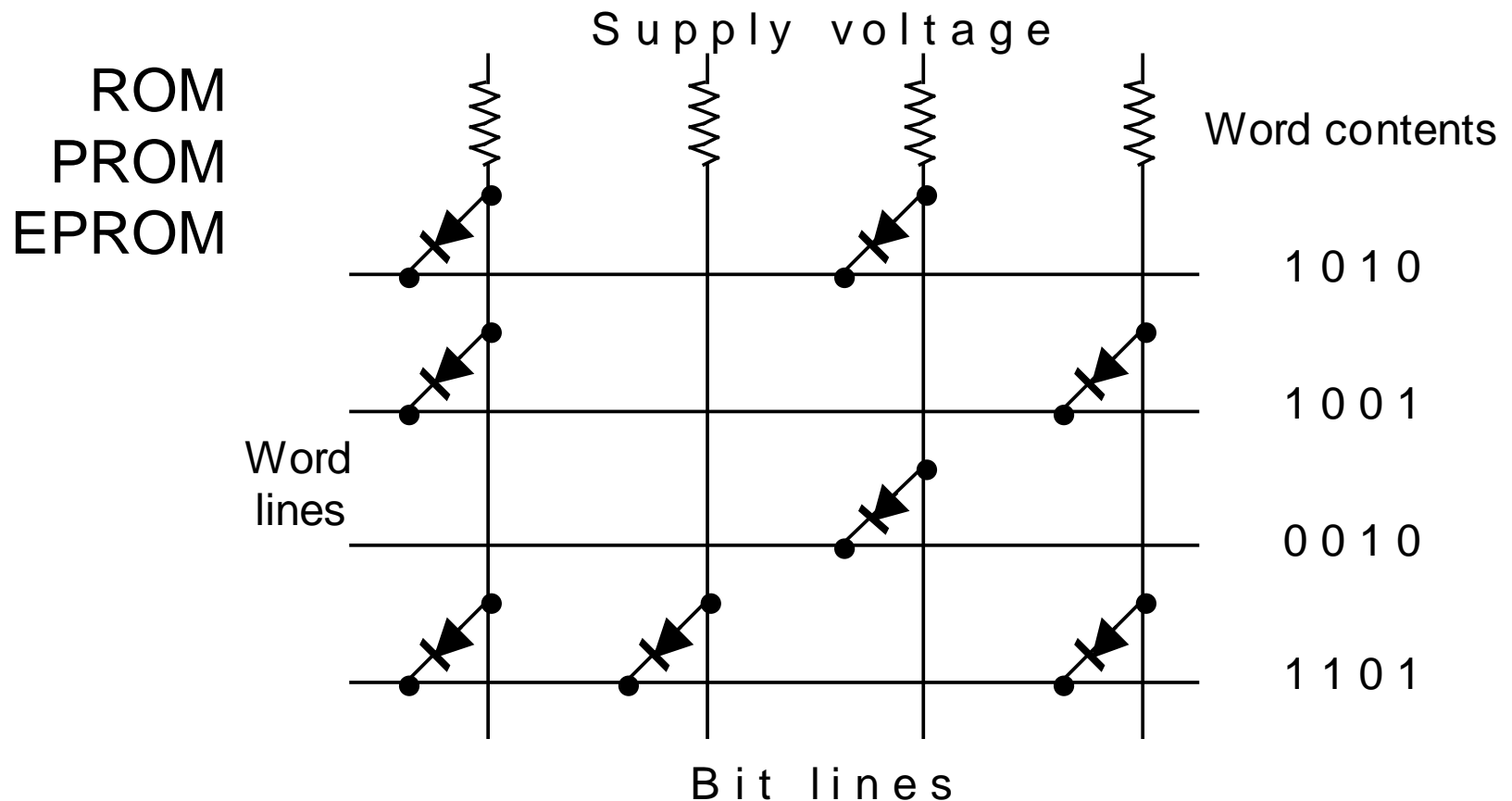
Memorie cache în bandă de asamblare

Întrețeserea memoriei



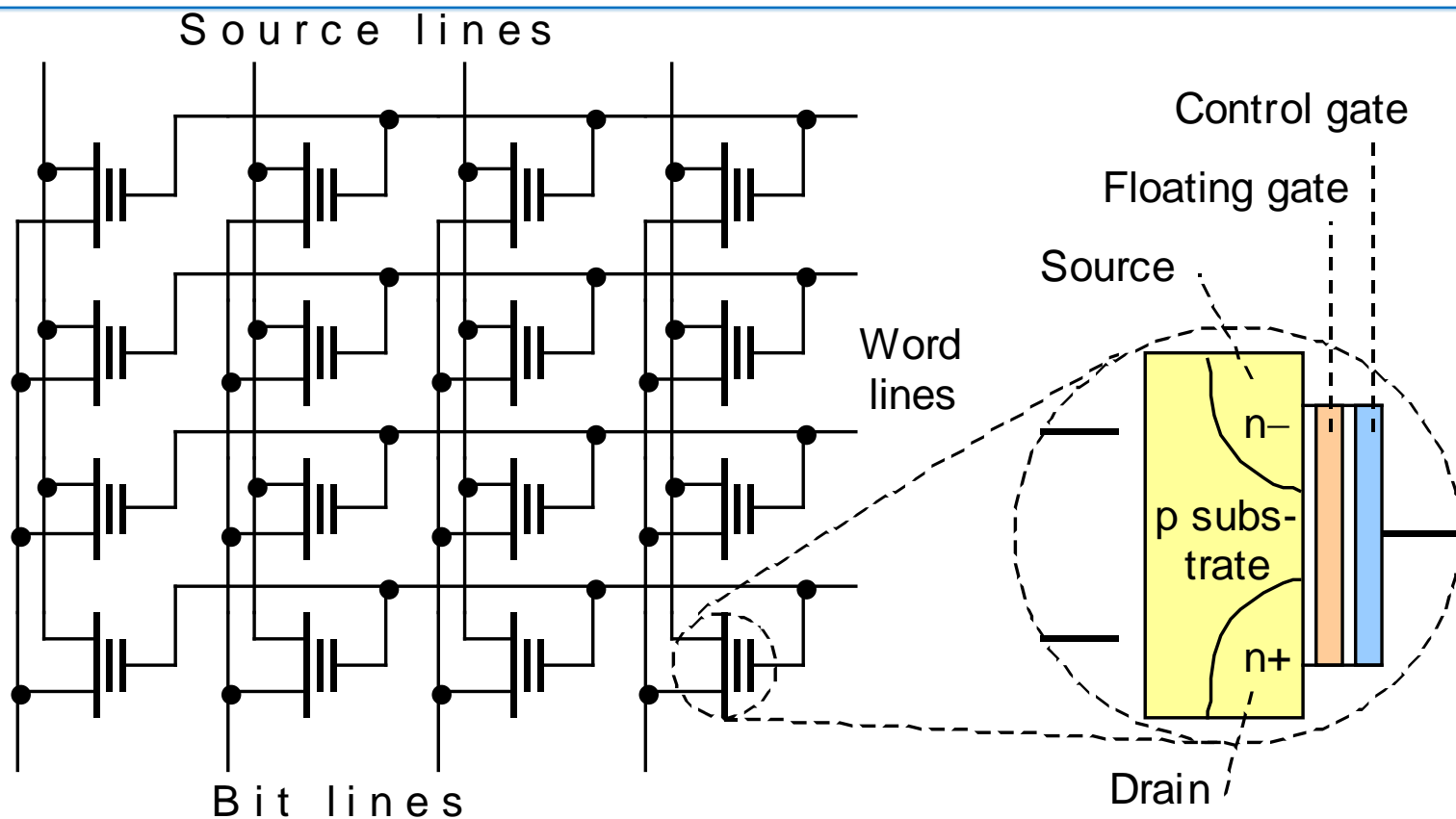
Memoria întrețesută e mai flexibilă decât memoria cu lățime de bandă mare, pentru că poate susține accese multiple independente în același timp.

Memoria ne-volatilă



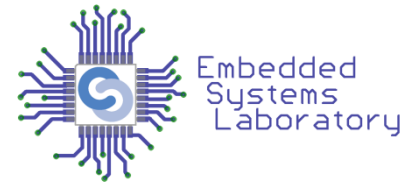
Organizarea Read-Only Memory. Conținutul memoriei este afișat în dreapta.

Memoria Flash



Organizarea memoriei EEPROM sau Flash. Fiecare celulă conține un tranzistor MOS cu poartă flotantă.

Nevoia unei ierarhii de memorie



Discrepanța în latență dintre CPU și memoria principală

Operațiile unui procesor sunt de ordinul nanosecundelor

Accesele la memorie necesită timpi de ordinul zecilor sau sutelor de ns

Limitările lățimii de bandă pentru memorii reduc rata de execuție a instrucțiunilor

Fiecare instrucțiune executată necesită cel puțin un acces la memorie

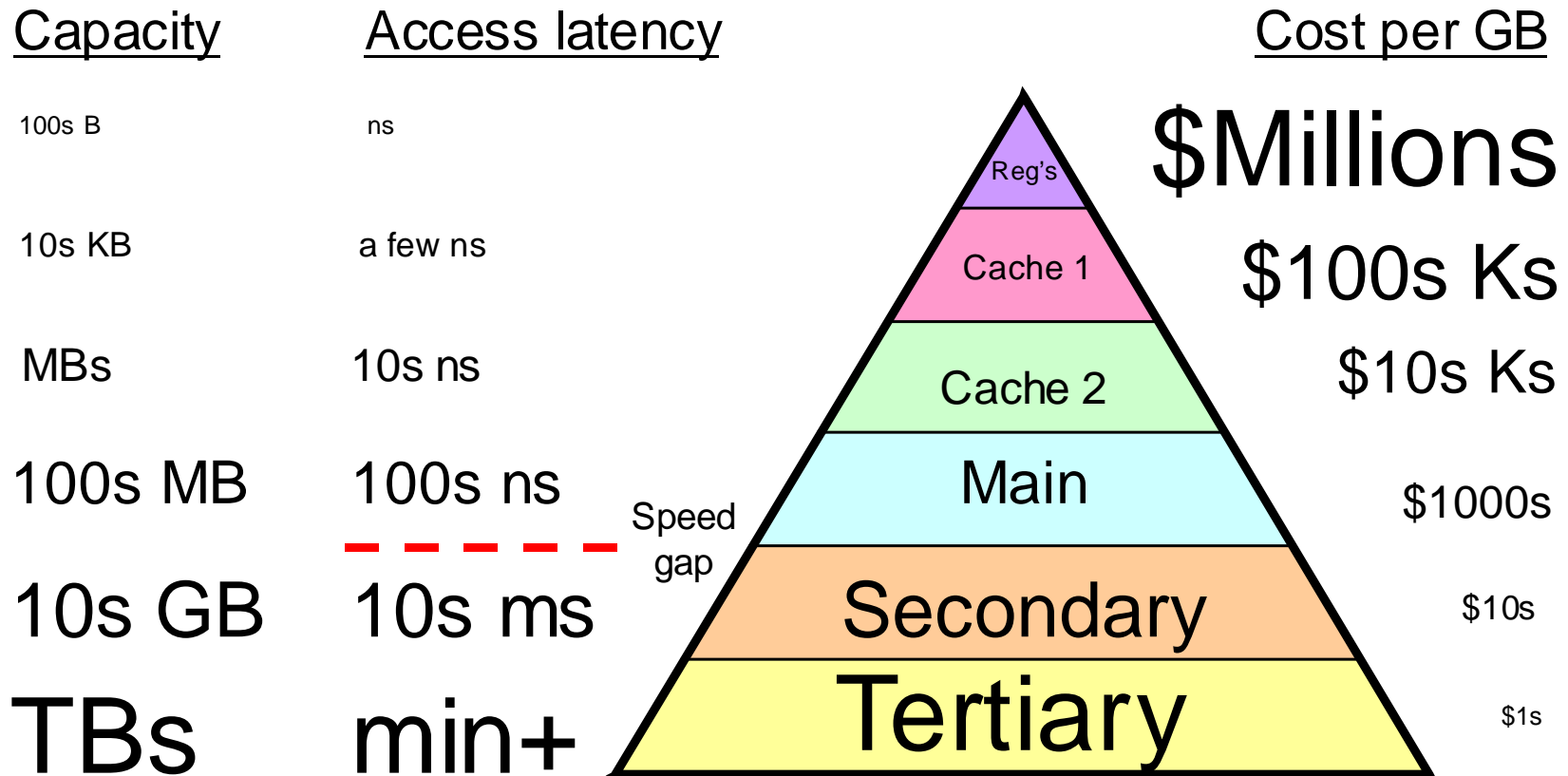
Rezultă că performanța procesorului este redusă la câteva sute de MIPS

O memorie rapidă poate reduce timpii de acces la date

Cele mai rapide memorii sunt costisitoare și nu au capacitate mare.

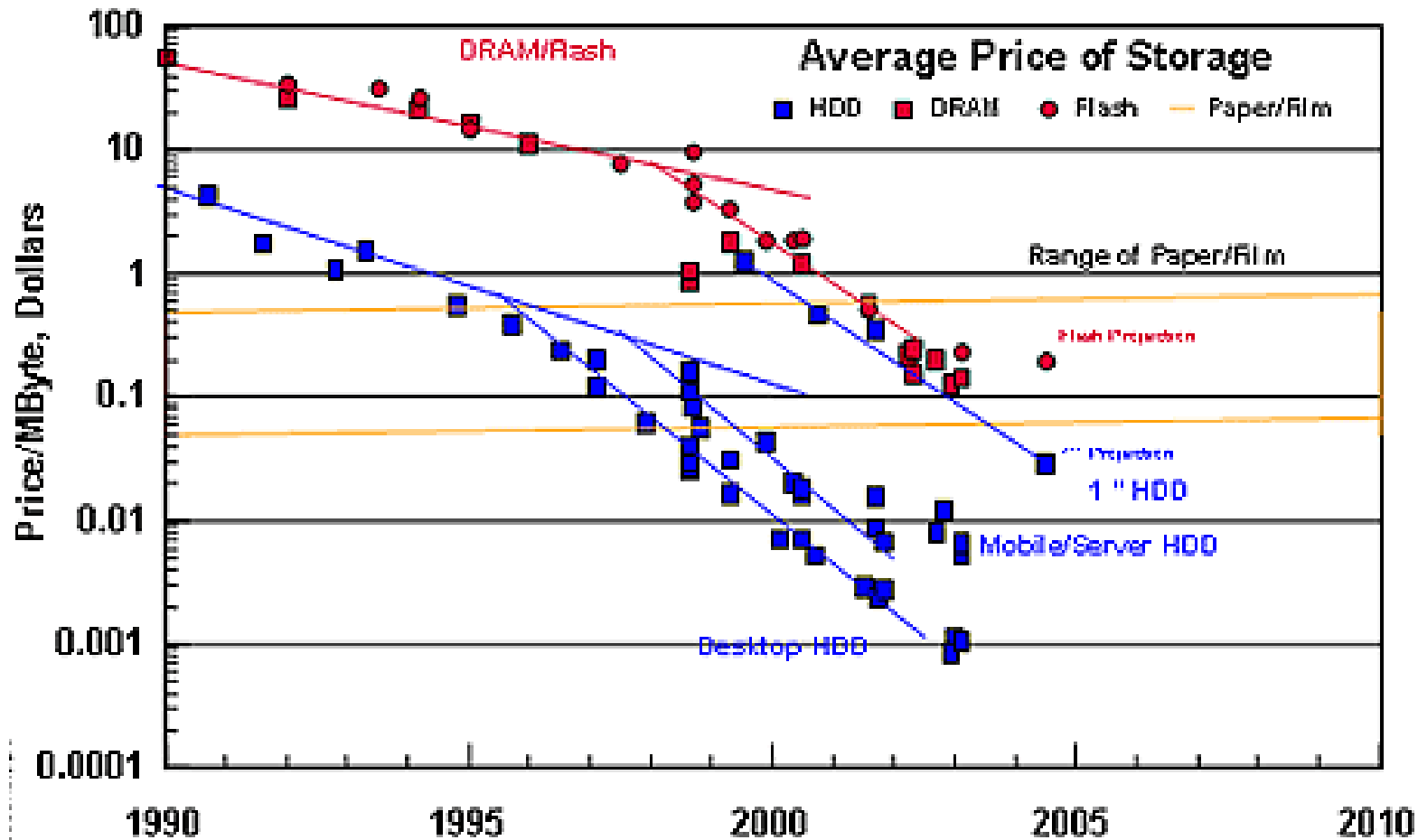
Două (sau trei) niveluri de cache sunt folosite, din această cauză

Ierarhia tipică a circuitelor de memorie



Numele și caracteristicile tipice pentru memorii în organizarea ierarhică

Tendențele prețurilor memorii



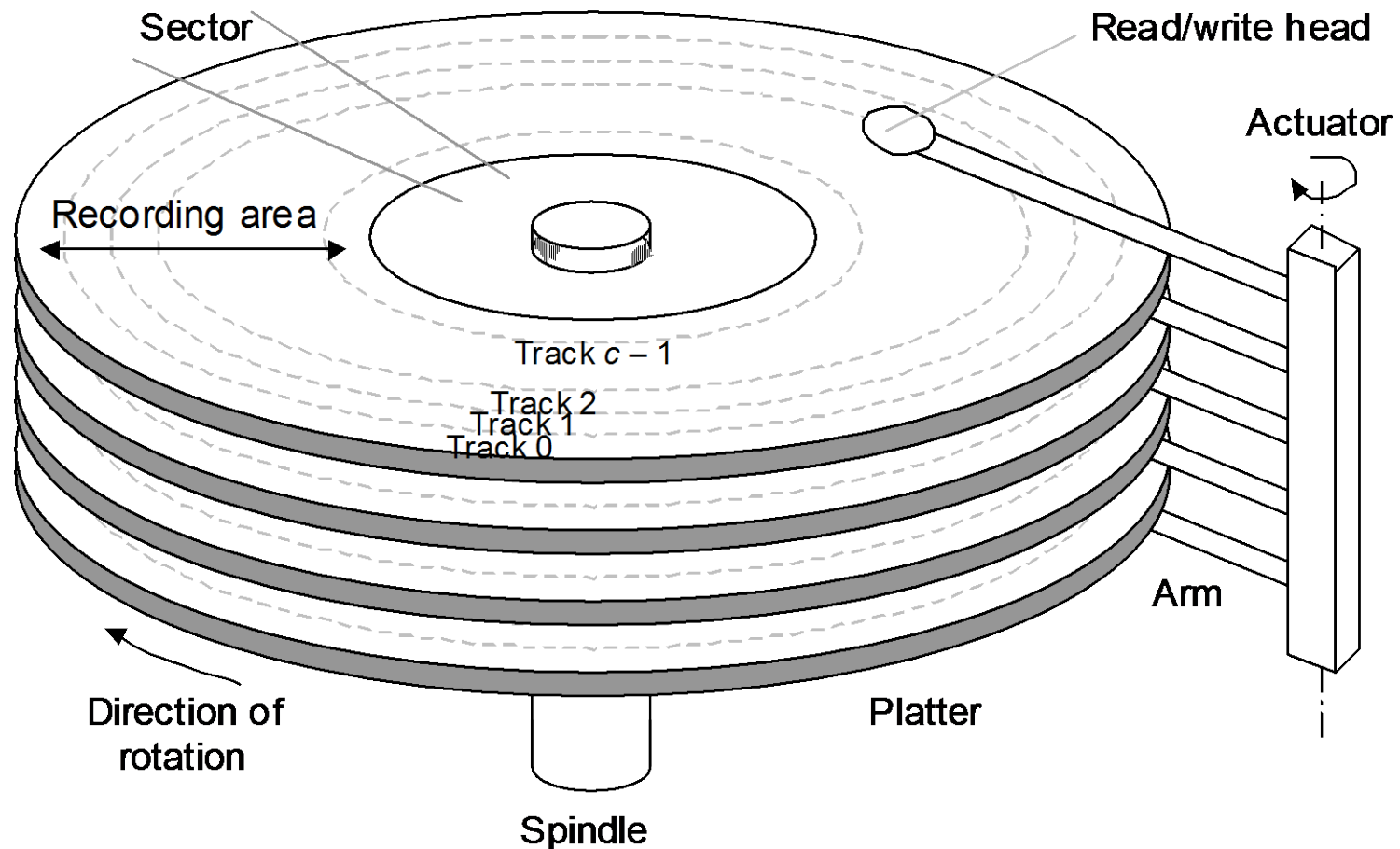
Source: <https://www1.hitachigst.com/hdd/technolo/overview/chart03.html>

Memorii de mare capacitate

În zilele noastre, memoria principală este imensă, totuși inadecvată pentru toate necesitățile

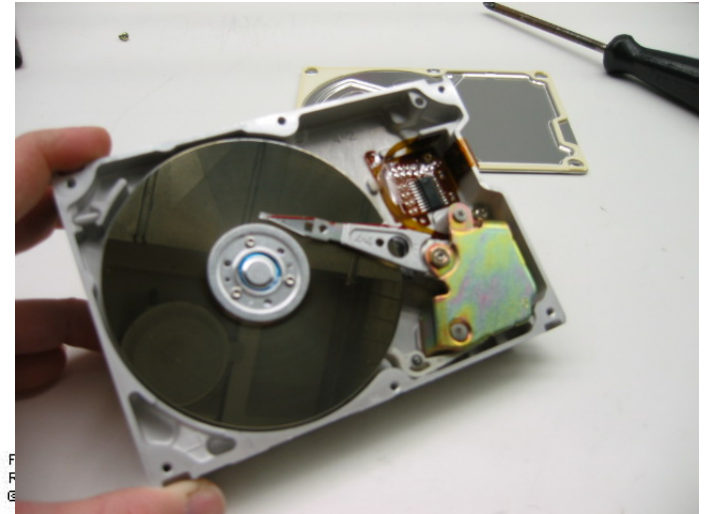
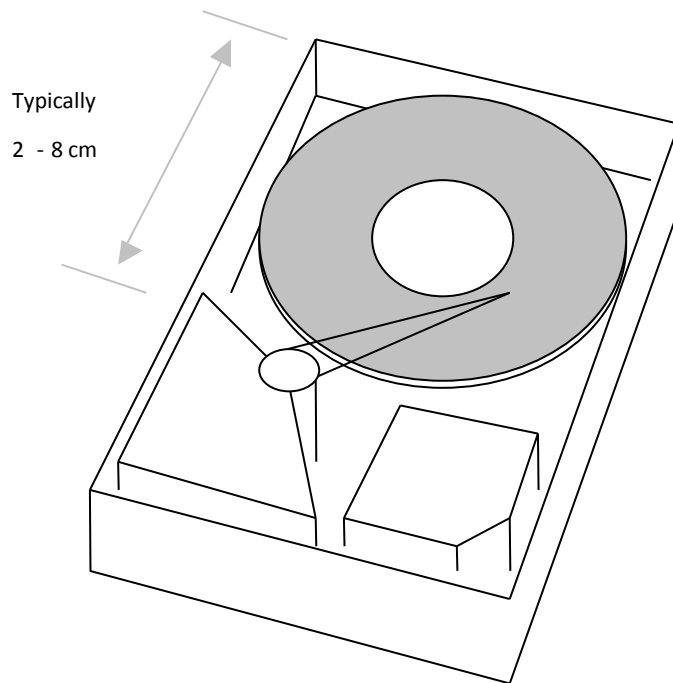
- Discurile magnetice furnizează capacități extinse pentru stocare și back-up
- Discurile optice și memoriile solid-state sunt alte opțiuni de stocare a datelor

Disk Memory 101



Elementele unui hard-disc și termenii principali.

Unități de disc

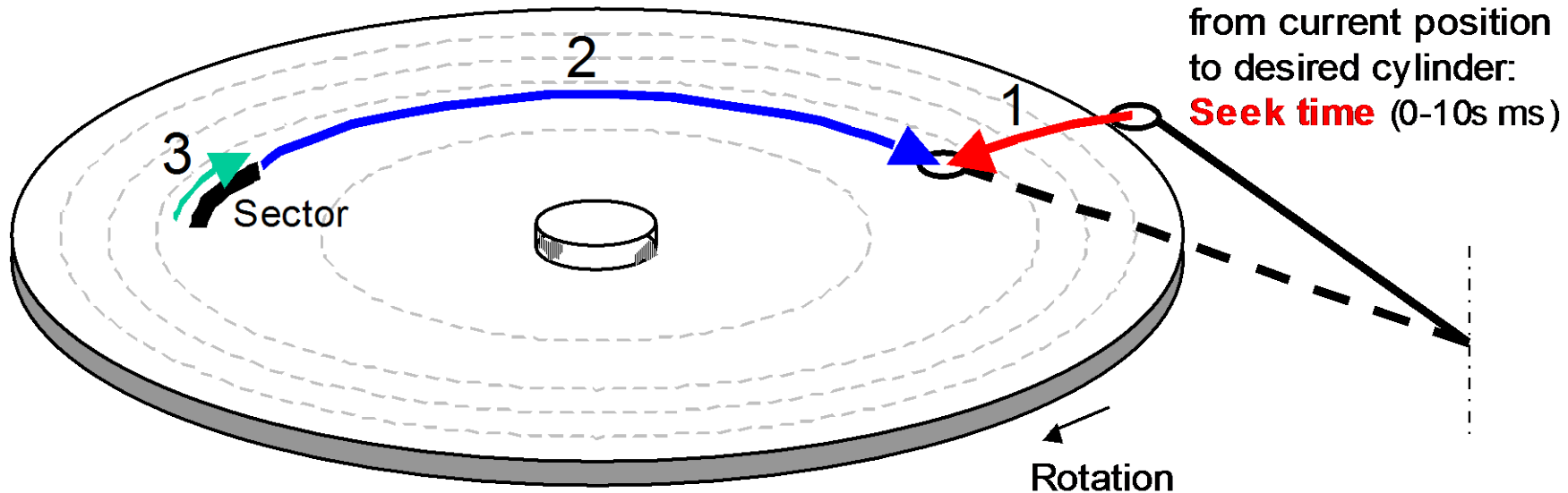


Timpul de acces pentru un disc

3. Disk rotation until sector has passed under the head:
Data transfer time (< 1 ms)

2. Disk rotation until the desired sector arrives under the head:
Rotational latency (0-10s ms)

1. Head movement from current position to desired cylinder:
Seek time (0-10s ms)



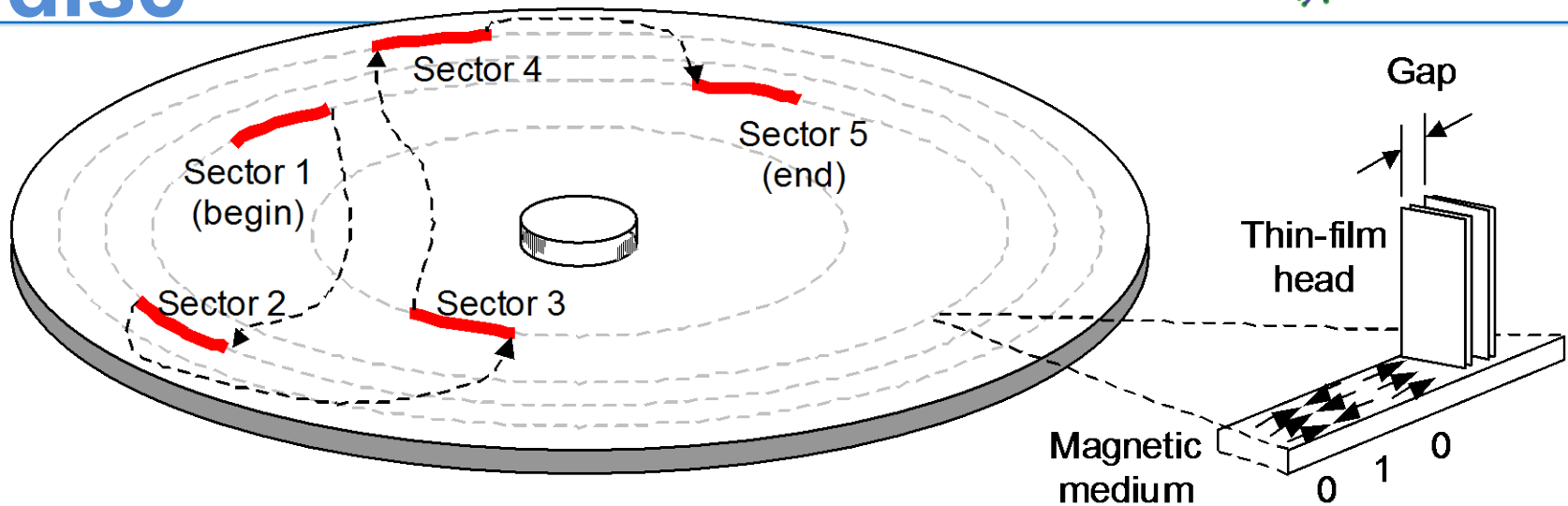
Cele trei componente ale timpului de acces la un disc. Discurile cu o viteză de rotație mai mare au timpi de acces mai buni, atât în medie cât și în cel mai rău caz.

Discuri magnetice

Caracteristicile a trei tipuri diferite de discuri magnetice (ca. 2003)

Manufacturer and Model Name	Seagate Barracuda 180	Hitachi DK23DA	IBM Microdrive
Application domain	Server	Laptop	Pocket device
Capacity	180 GB	40 GB	1 GB
Platters / Surfaces	12 / 24	2 / 4	1 / 2
Cylinders	24 247	33 067	7 167
Sectors per track, avg	604	591	140
Buffer size	16 MB	2 MB	1/8 MB
Seek time, min,avg,max	1, 8, 17 ms	3, 13, 25 ms	1, 12, 19 ms
Diameter	3.5"	2.5"	1.0"
Rotation speed, rpm	7 200	4 200	3 600
Typical power	14.1 W	2.3 W	0.8 W

Organizarea datelor pe disc



Înregistrarea magnetică a datelor pe piste și capul de citire/scriere.

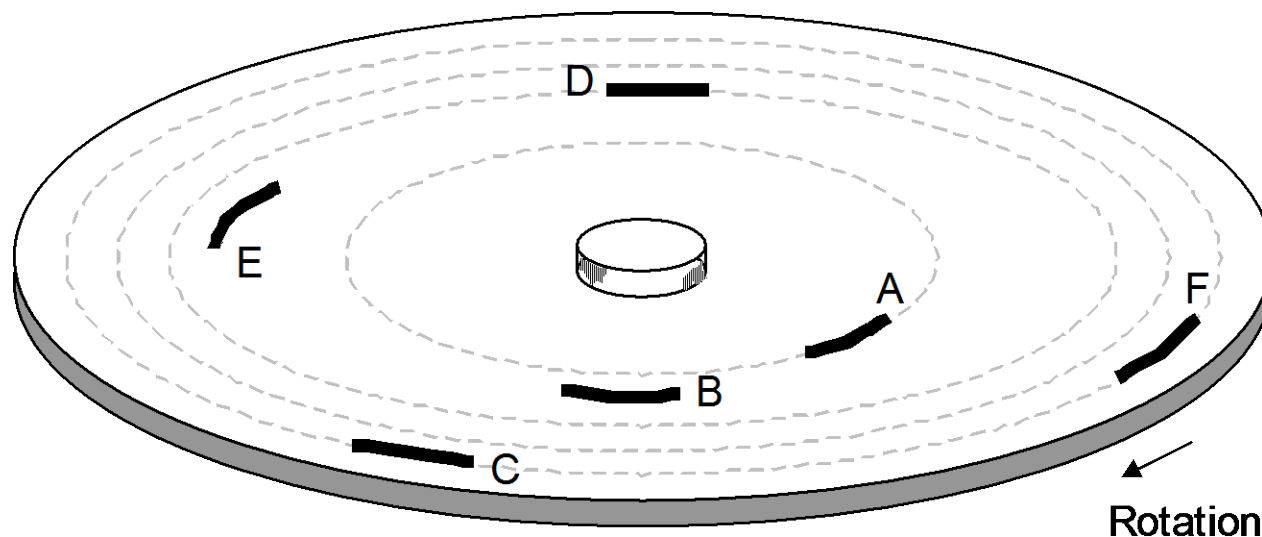
0	16	32	48	1	17	33	49	2		Track i
30	46	62	15	31	47	0	16	32		Track $i + 1$
60	13	29	45	61	14	30	46	62		Track $i + 2$
27	43	59	12	28	44	60	13	29		Track $i + 3$

Numerotarea logică a sectoarelor pe mai multe piste adiacente.

Performanța discurilor

Timpul de căutare = $a + b(c - 1) + \beta(c - 1)^{1/2}$

Latență medie dată de rotire = $(30 / \text{rpm}) \text{ s} = (30\,000 / \text{rpm}) \text{ ms}$



Arrival order of
access requests:

A, B, C, D, E, F

Possible out-of-
order reading:

C, F, D, E, B, A

Reducerea timpului de căutare și a latenței de rotire prin accesarea datelor în altă ordine.

Disk Caching

Aceeași idee ca și la caching-ul pentru procesoare: micșorarea latenței dintre memori principală și disc

Discurile au memorii tampon în funcție de capacitate (de ordinul 10-100 MB)

Latența datorată rotației este eliminată; pot să înceapă de la orice sector

Am nevoie de energie pentru back-up pentru a nu pierde schimbările din memoria tampon

(ne trebuie oricum o rezervă de energie pentru retragerea capului de citire la căderea sursei de energie electrică)

Opțiuni de plasare a memoriei cache pentru discuri

În controllerul de disc:

Suntem afectați de latența magistralei de date și a controllerului în sine, chiar și pentru un cache hit

Mai aproape de CPU:

Reduce latența și permite o utilizare mai bună a spațiului

Soluții intermediare sau mixte

Disk Arrays & RAID

Necesitatea de memorii secundare (disc) de capacitate și productivitate mărită

Processor speed	RAM size	Disk I/O rate	Number of disks	Disk capacity	Number of disks
1 GIPS	1 GB	100 MB/s	1	100 GB	1
1 TIPS	1 TB	100 GB/s	1000	100 TB	100
1 PIPS	1 PB	100 TB/s	1 Million	100 PB	100 000
1 EIPS	1 EB	100 PB/s	1 Billion	100 EB	100 Million

1 RAM byte
pentru fiecare IPS

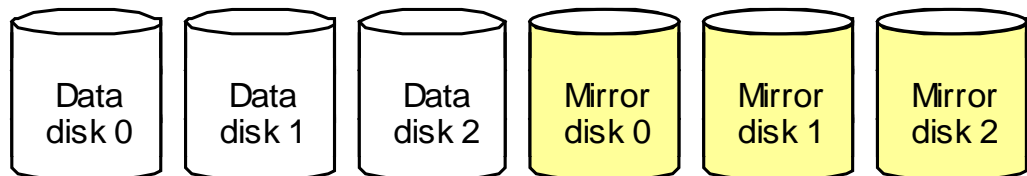
1 I/O bit/sec
pentru fiecare IPS

100 disk bytes
pt. fiecare RAM byte

**Legea lui
Amdahl
pentru un
sistem bine
echilibrat**

Redundant Array of Independent Disks (RAID)

Data organization on multiple disks



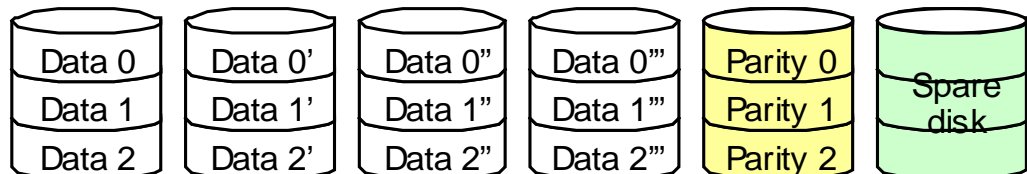
RAID0: Multiple disks for higher data rate; no redundancy

RAID1: Mirrored disks

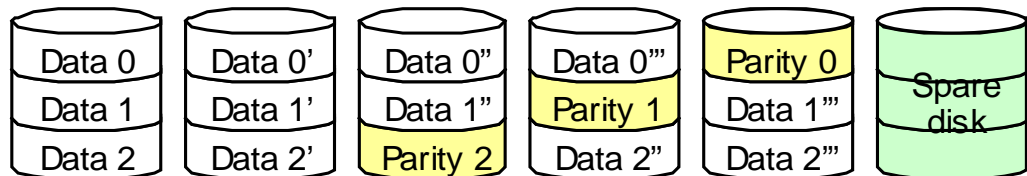


RAID2: Error-correcting code

RAID3: Bit- or byte-level striping with parity/checksum disk



RAID4: Parity/checksum applied to sectors, not bits or bytes



RAID5: Parity/checksum distributed across several disks

RAID6: Parity and 2nd check distributed across several disks

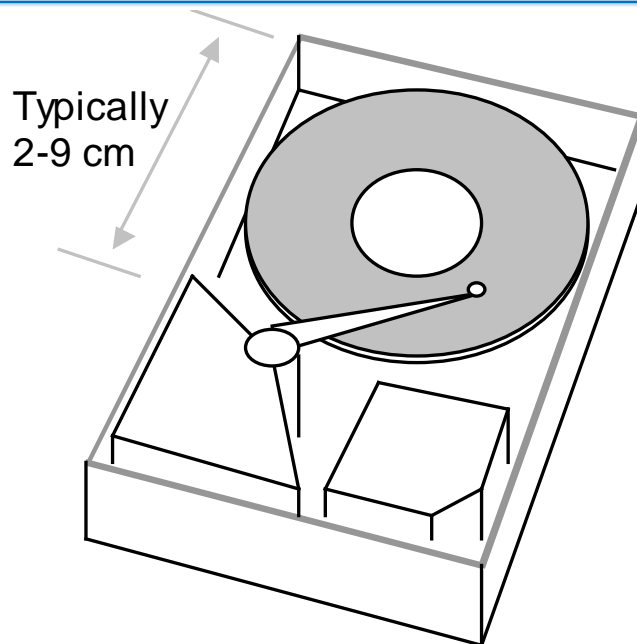
Nivelurile 0-6 RAID, cu o vedere simplificată a organizării datelor.

Exemple de produse RAID

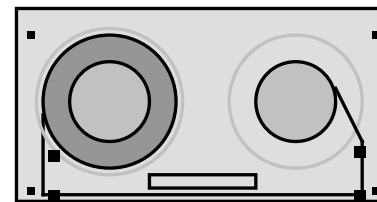
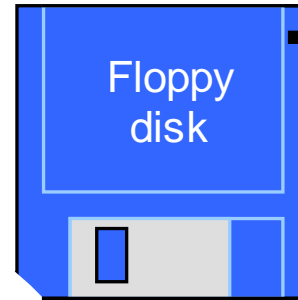


IBM ESS Model 750

Alte tipuri de medii de stocare



(a) Cutaway view of a hard disk drive



Magnetic
tape
cartridge

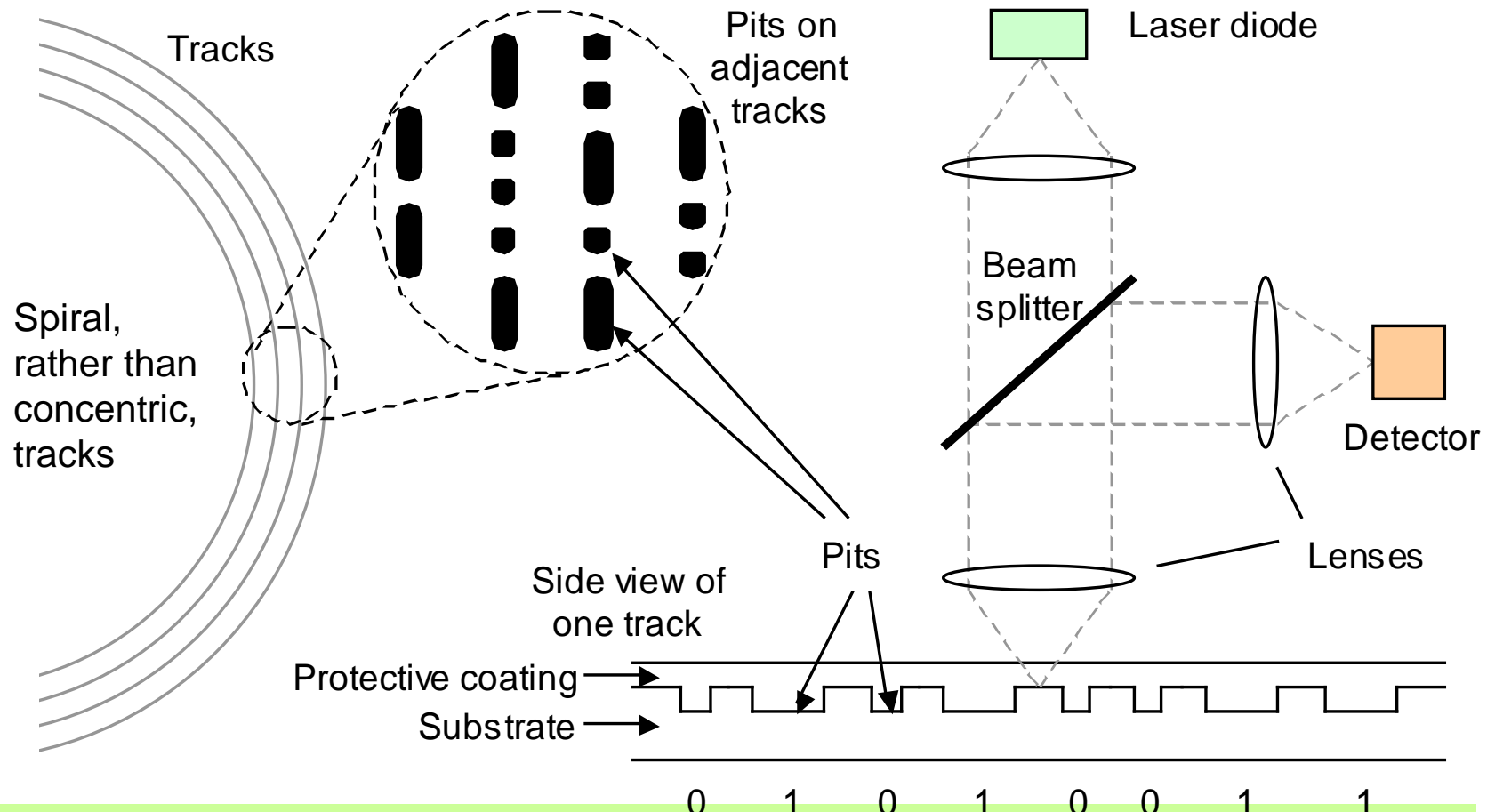
(b) Some removable storage media

Unități de memorie
magnetice, electrice și
optice.

Flash drive
Thumb drive
Travel drive



Discuri optice



Vedere simplificată a înregistrărilor și mecanismul de acces la date pentru un CD-ROM sau DVD-ROM.

Biblioteci automate de benzi pentru arhivare

